LM158, LM158A, LM258, LM258A
LM2904, LM2904B, LM2904BA, LM2904V
LM358, LM358A, LM358B, LM358BA
ZHCSIT6AB – JUNE 1976 – REVISED OCTOBER 2024

行业标准双路运算放大器

1 特性

- 3V 至 36V 的宽电源电压范围（B、BA 版本）
- 静态电流：300 μA/通道（B、BA 版本）
- 单位增益带宽为 1.2 MHz（B、BA 版本）
- 共模输入电压范围包括接地，支持近地直接感测
- 25°C 时的最大输入失调电压为 2mV（BA 版本）
- 25°C 时的最大输入失调电压为 3mV（A、B 版本）
- 内部射频和 EMI 滤波器（B、BA 版本）
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品，所有参数均经过测试，除非另有说明。对于所有其他产品，生产流程不一定包含对所有参数的测试。

2 应用

- 商用网络和服务器电源单元
- 多功能打印机
- 电源和移动充电器
- 电机控制：交流感应、有刷直流、无刷直流、高压、低压、永磁和步进电机
- 台式计算机和主板
- 室内外空调
- 洗衣机、烘干机和冰箱
- 交流逆变器、串式逆变器、中央逆变器和变频器
- 不间断电源
- 电子销售点系统

3 说明

LM358B 和 LM2904B 器件是行业标准运算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本，其中包括两个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值，其特性包括低失调电压（300μV，典型值）、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。

LM358B 和 LM2904B 运算放大器利用单位增益稳定性、更低的失调电压（最大值为 3mV；LM358BA 和 LM2904BA 的最大值为 2mV）和更低的静态电流（每个放大器为 300μA 典型值）等增强型特性简化了电路设计。高 ESD（2kV，HBM）和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM358B 和 LM2904B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM358B 和 LM2904B 放大器采用微型封装（如 SOT23-8），以及行业标准封装（包括 SOIC、TSSOP 和 VSSOP）。

封装信息

器件型号(1)	封装	封装尺寸(2)
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A	D（SOIC，8）	4.9mm × 6mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2490V	PW（TSSOP，8）	3mm × 6.4mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A	DGK（VSSOP，8）	3mm × 4.9mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA	DDF（SOT-23，8）	2.9mm × 2.8mm
LM358、LM2904	PS（SO，8）	6.2mm × 7.8mm
LM358、LM2904、LM358A、LM258、LM258A	P（PDIP，8）	9.81mm × 9.43mm
LM158、LM158A	JG（CDIP，8）	9.6mm × 6.67mm
LM158、LM158A	FK（LCCC，20）	8.89mm × 8.89mm

系列产品比较

规格	LM358B LM358BA	LM2904B LM2904BA	LM358 LM358A	LM2904	LM2904V LM2904AV	LM258 LM258A	LM158 LM158A	单位
电源电压	3 至 36	3 至 36	3 至 30	3 至 26	3 至 30	3 至 30	3 至 30	V
失调电压（25°C 时的最大值）	± 3 ± 2	± 3 ± 2	±7 ±3	±7	±7 ±2	±5 ±3	±5 ±2	mV
输入偏置电流（典型值/最大值）	10/35	10/35	20/250 15/100	20/250	20/250	20/150 15/80	20/150 15/50	nA
增益带宽积	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	MHz
电源电流（每通道的典型值）	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	mA
ESD (HBM)	2000	2000	500	500	500	500	500	V
工作环境温度	-40 至 85	-40 至 125	0 至 70	-40 至 125	-40 至 125	-25 至 85	-55 至 125	°C

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

内容

1 特性 1
2 应用 1
3 说明 1
4 引脚配置和功能 3
5 规格 4
5.1 绝对最大额定值 4
5.2 ESD 等级 4
5.3 建议运行条件 5
5.4 热性能信息 5
5.5 电气特性：LM358B 和 LM358BA 6
5.6 电气特性：LM2904B 和 LM2904BA 9
5.7 电气特性：LM358、LM358A 11
5.8 电气特性：LM2904、LM2904V 13
5.9 电气特性：LM158、LM158A 15
5.10 电气特性：LM258、LM258A 17
5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B 18
5.12 典型特性：LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V 25
6 参数测量信息 27
7 详细说明 28
7.1 概述 28
7.2 功能方框图：LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA 28
7.3 特性说明 29
7.4 器件功能模式 29
8 应用和实现 30
8.1 应用信息 30
8.2 典型应用 30
8.3 电源相关建议 31
8.4 布局 31
9 器件和文档支持 33
9.1 接收文档更新通知 33
9.2 支持资源 33
9.3 商标 33
9.4 静电放电警告 33
9.5 术语表 33
10 修订历史记录 33
11 机械、封装和可订购信息 35

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能

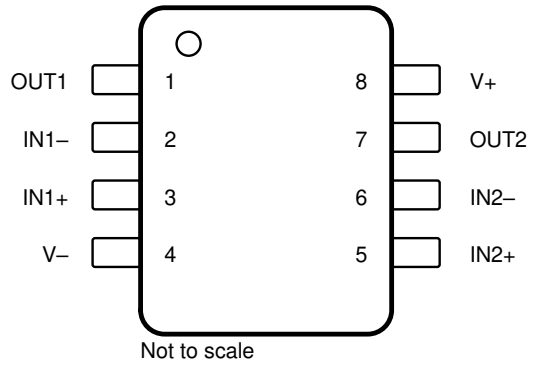
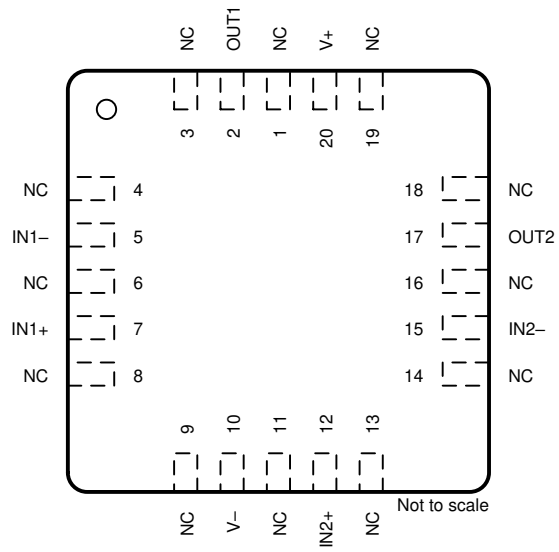


图 4-1. D、DDF、DGK、P、PS、PW 和 JG 封装 8 引脚 SOIC、SOT23-8、VSSOP、PDIP、SO、TSSOP 和 CDIP 顶视图



NC - 无内部连接

图 4-2. FK 封装 20 引脚 LCCC 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚			I/O	说明
名称	LCCC(1)	SOIC、SOT23-8、VSSOP、CDIP、PDIP、SO、TSSOP、CFP(1)		
IN1 –	5	2	I	负输入
IN1+	7	3	I	正输入
IN2 –	15	6	I	负输入
IN2+	12	5	I	正输入
OUT1	2	1	O	输出
OUT2	17	7	O	输出
V –	10	4	—	负（最低）电源或接地（对于单电源供电）
NC	1、3、4、6、8、9、11、13、14、16、18、19	—	—	没有与内部电路连接
V+	20	8	—	正（最高）电源

(1) 有关器件列表及器件采用的具体封装，请参阅节 3。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作环境温度范围内（除非另外注明）(1)

			最小值	最大值	单位
电源电压，V_S = ([V+] – [V –])		LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA		±20 或 40	V
		LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V		±16 或 32	
		LM2904		±13 或 26	
差分输入电压，V_{ID} (2)		LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V	-32	32	V
		LM2904	– 26	26	
输入电压，V_I	任一输入	LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA	-0.3	40	V
		LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V	– 0.3	32	
		LM2904	-0.3	26	
输出对地短路（一个放大器）的持续时间（在或低于 T_A = 25°C、V_S ≤ 15V 条件下）(3)				无限	s
工作环境温度，T_A		LM158、LM158A	– 55	125	°C
		LM258、LM258A	– 25	85	
		LM358B、LM358BA	– 40	85	
		LM358、LM358A	0	70	
		LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V	-40	125	
运行虚拟结温，T_J				150	°C
贮存温度，T_{stg}			-65	150	°C

(1) 超出*绝对最大额定值*下所列的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在*建议运行条件*以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于最大绝对额定情况下会影响设备的可靠性。
(2) 差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。
(3) 从输出到 V_S 的短路会导致过热，并且最终会发生损坏。

5.2 ESD 等级

		值	单位
LM358B、LM358BA、LM2904B 和 LM2904BA			
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)	±2000	V
	充电器件模型（CDM），符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±1500	
LM158、LM258、LM358、LM158、LM258A、LM358A、LM2904 和 LM2904V			
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)	±500	V
	充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±1000	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出：250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.3 建议运行条件

在工作环境温度范围内测得（除非另外注明）

			最小值	最大值	单位
V_S	电源电压，V_S= ([V+] – [V –])	LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA	3	36	V
		LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V	3	30	
		LM2904	3	26	
V_{CM}	共模电压		V –	V+ – 2	V
T_A	工作环境温度	LM358B、LM358BA	– 40	85	°C
		LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V	-40	125	
		LM358、LM358A	0	70	
		LM258、LM258A	-20	85	
		LM158、LM158A	– 55	125	

5.4 热性能信息

热指标(1)		LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM358B、LM358BA、LM2904、LM2904B、LM2904BA、LM2904V(2)						LM158、LM158A		单位
		D (SOIC)	DGK (VSSOP)	P (PDIP)	PS (SO)	PW (TSSOP)	DDF (SOT-23)	FK (LCCC)	JG (CDIP)	
		8 个引脚	8 个引脚	8 个引脚	8 个引脚	8 个引脚	8 个引脚	20 个引脚	8 个引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	124.7	181.4	80.9	116.9	171.7	164.3	84.0	112.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	66.9	69.4	70.4	62.5	68.8	98.1	56.9	63.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	67.9	102.9	57.4	68.6	99.2	82.1	57.5	100.3	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	19.2	11.8	40	21.9	11.5	11.4	51.7	35.7	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	67.2	101.2	56.9	67.6	97.9	81.7	57.1	93.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	—	—	—	—	—	—	10.6	22.3	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*。
(2) 有关器件列表及器件采用的具体封装，请参阅*节 3*。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.5 电气特性：LM358B 和 LM358BA

在 V_S = (V+) – (V–) = 5V 至 36V（±2.5V 至 ±18V）、T_A = 25°C、V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2、R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2）条件下测得
（除非另有说明）

参数		测试条件			最小值	典型值	最大值	单位
失调电压								
V_{OS}	输入失调电压	LM358B				±0.3	±3.0	mV
				T_A = -40°C 至 +85°C			±4	mV
		LM358BA					±2.0	mV
				T_A = -40°C 至 +85°C			±2.5	mV
dV_{OS}/d_T	输入失调电压温漂			T_A = -40°C 至 +85°C(1)		±3.5	11	μV/°C
PSRR	电源抑制比					±2	15	μV/V
	通道分离，直流	f = 1kHz 至 20kHz				±1		μV/V
输入电压范围								
V_{CM}	共模电压范围	V_S = 3V 至 36V					(V+) – 1.5	V
		V_S = 5V 至 36V		T_A = -40°C 至 +85°C	(V–)		(V+) – 2	V
CMRR	共模抑制比	(V–) ≤ V_{CM} ≤ (V+) – 1.5V	V_S = 3V 至 36V			20	100	μV/V
		(V–) ≤ V_{CM} ≤ (V+) – 2.0V	V_S = 5V 至 36V	T_A = -40°C 至 +85°C		25	316	
输入偏置电流								
I_B	输入偏置电流					-10	-35	nA
				T_A = -40°C 至 +85°C(1)			-50	nA
I_{OS}	输入失调电流					0.5	4	nA
				T_A = -40°C 至 +85°C(1)			5	nA
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移			T_A = -40°C 至 +85°C		10		pA/℃
噪声								
E_n	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz				3		μV_{PP}
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz				40		nV/√Hz
输入阻抗								
Z_{ID}	差分					10 || 0.1		MΩ || pF
Z_{IC}	共模					4 || 1.5		GΩ || pF
开环增益								
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V；V_O = 1V 至 11V；R_L ≥ 10kΩ（连接到 (V-)）			70	140		V/mV
				T_A = -40°C 至 +85°C	35			V/mV
频率响应								
GBW	增益带宽积					1.2		MHz
SR	压摆率	G = +1				0.5		V/μs
Θ_m	相位裕度	G = + 1，R_L = 10kΩ，C_L = 20pF				56		°
t_{OR}	过载恢复时间	V_{IN} × 增益 > V_S				10		μs
t_s	稳定时间	精度达到 0.1%，V_S = 5V，2V 阶跃，G = +1，C_L = 100pF				4		μs
THD+N	总谐波失真 + 噪声	G = +1，f = 1kHz，V_O = 3.53V_{RMS}，V_S = 36V，R_L = 100k，I_{OUT} ≤ ±50μA，BW = 80kHz				0.001		%
输出								
V_O	相对于电源轨的电压输出摆幅	正电源轨 (V+)		I_{OUT} = 50μA		1.35	1.42	V
				I_{OUT} = 1mA		1.4	1.48	V
				I_{OUT} = 5mA(1)		1.5	1.61	V
		负电源轨 (V–)		I_{OUT} = 50μA		100	150	mV
				I_{OUT} = 1mA		0.75	1	V
			V_S = 5V，RL ≤ 10kΩ（连接到 (V–)）	T_A = -40°C 至 +85°C		5	20	mV

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.5 电气特性：LM358B 和 LM358BA（续）

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V 至 36V（±2.5V 至 ±18V）、T_A = 25°C、V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2、R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2）条件下测得
（除非另有说明）

参数		测试条件			最小值	典型值	最大值	单位
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = V –；V_{ID} = 1V	拉电流(1)		-20	-30		mA
				T_A = -40°C 至 +85°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = V+；V_{ID} = –1V	灌电流(1)		10	20		
				T_A = -40°C 至 +85°C	5			
		V_{ID} = –1V；V_O = (V –) + 200mV			60	100		µA
I_{SC}	短路电流	V_S = 20V，(V+) = 10V，(V –) = –10V，V_O = 0V				±40	±60	mA
C_{LOAD}	容性负载驱动					100		pF
R_O	开环输出电阻	f = 1MHz，I_O = 0A				300		Ω

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.5 电气特性：LM358B 和 LM358BA（续）

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V 至 36V（±2.5V 至 ±18V）、T_A = 25°C、V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2、R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2）条件下测得
（除非另有说明）

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
电源							
I_Q	每个放大器的静态电流	V_S = 5V，I_O = 0A	T_A = -40°C 至 +85°C		300	460	μA
I_Q	每个放大器的静态电流	V_S = 36V，I_O = 0A				800	μA

(1) 仅由特性确定。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.6 电气特性：LM2904B 和 LM2904BA

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V 至 36V (±2.5V 至 ±18V) 、T_A = 25°C、V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2、R_L = 10k (连接至 V_S/2) 条件下测得
(除非另有说明)

参数		测试条件			最小值	典型值	最大值	单位
失调电压								
V_{OS}	输入失调电压	LM2904B				±0.3	±3.0	mV
				T_A = -40°C 至 +125°C			±4	mV
		LM2904BA					±2.0	mV
				T_A = -40°C 至 +125°C			±3.0	mV
dV_{OS}/d_T	输入失调电压温漂			T_A = -40°C 至 +125°C(1)		±3.5	12	μV/°C
PSRR	电源抑制比					±2	15	μV/V
	通道分离，直流	f = 1kHz 至 20kHz				±1		μV/V
输入电压范围								
V_{CM}	共模电压范围	V_S = 3V 至 36V					(V+) – 1.5	V
		V_S = 5V 至 36V		T_A = -40°C 至 +125°C	(V –)		(V+) – 2	V
CMRR	共模抑制比	(V –) ≤ V_{CM} ≤ (V+) – 1.5V	V_S = 3V 至 36V			20	100	μV/V
		(V –) ≤ V_{CM} ≤ (V+) – 2.0V	V_S = 5V 至 36V	T_A = -40°C 至 +125°C		25	316	
输入偏置电流								
I_B	输入偏置电流					-10	-35	nA
				T_A = -40°C 至 +125°C(1)			-50	nA
I_{OS}	输入失调电流					0.5	4	nA
				T_A = -40°C 至 +125°C(1)			5	nA
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移			T_A = -40°C 至 +125°C		10		pA/℃
噪声								
E_n	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz				3		μV_{PP}
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz				40		nV/√Hz
输入阻抗								
Z_{ID}	差分					10 || 0.1		MΩ || pF
Z_{IC}	共模					4 || 1.5		GΩ || pF
开环增益								
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V ; V_O = 1V 至 11V ; R_L ≥ 10kΩ，连接至 (V-)			70	140		V/mV
				T_A = -40°C 至 +125°C	35			V/mV
频率响应								
GBW	增益带宽积					1.2		MHz
SR	压摆率	G = +1				0.5		V/μs
Θ_m	相位裕度	G = + 1，R_L = 10kΩ，C_L = 20pF				56		°
t_{OR}	过载恢复时间	V_{IN} × 增益 > V_S				10		μs
t_s	稳定时间	精度达到 0.1%，V_S = 5V，2V 阶跃，G = +1，C_L = 100pF				4		μs
THD+N	总谐波失真 + 噪声	G = +1，f = 1kHz，V_O = 3.53V_{RMS}，V_S = 36V，R_L = 100k，I_{OUT} ≤ ±50μA，BW = 80kHz				0.001		%
输出								
V_O	相对于电源轨的电压输出摆幅	正电源轨 (V+)		I_{OUT} = 50μA		1.35	1.42	V
				I_{OUT} = 1mA		1.4	1.48	V
				I_{OUT} = 5mA(1)		1.5	1.61	V
		负电源轨 (V-)		I_{OUT} = 50μA		100	150	mV
				I_{OUT} = 1mA		0.75	1	V
			V_S = 5V，RL ≤ 10kΩ 连接到 (V –)	T_A = -40°C 至 +125°C		5	20	mV

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V 至 36V（±2.5V 至 ±18V）、T_A = 25°C、V_{CM} = V_{OUT} = V_S/2、R_L = 10k（连接至 V_S/2）条件下测得
（除非另有说明）

参数		测试条件			最小值	典型值	最大值	单位
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = V-；V_{ID} = 1V	拉电流(1)		-20	-30		mA
				T_A = -40°C 至 +125°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = V+；V_{ID} = 1V	灌电流(1)		10	20		
				T_A = -40°C 至 +125°C	5			
		V_{ID} = -1V；V_O = (V-) + 200mV			60	100		µA
I_{SC}	短路电流	V_S = 20V，(V+) = 10V，(V-) = -10V，V_O = 0V				±40	±60	mA
C_{LOAD}	容性负载驱动					100		pF
R_O	开环输出电阻	f = 1MHz，I_O = 0A				300		Ω
电源								
I_Q	每个放大器的静态电流	V_S = 5V，I_O = 0A		T_A = -40°C 至 +125°C		300	460	µA
I_Q	每个放大器的静态电流	V_S = 36V，I_O = 0A					800	µA

(1) 仅由特征确定。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.7 电气特性：LM358、LM358A

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下测得（除非另有说明）

参数		测试条件[1]			最小值	典型值[2]	最大值	单位
失调电压								
V_{OS}	输入失调电压	V_S = 5V 至 30V；V_{CM} = 0V；V_O = 1.4V	LM358			3	7	mV
				T_A = 0°C 至 70°C			9	
			LM358A			2	3	
				T_A = 0°C 至 70°C			5	
dV_{OS}/d_T	输入失调电压漂移		LM358	T_A = 0°C 至 70°C		7		μV/°C
			LM358A	T_A = 0°C 至 70°C		7	20	
PSRR	输入失调电压与电源电压间的关系（$\Delta V_{IO}/\Delta V_S$）	V_S=5 V 至 30 V			65	100		dB
V_{O1}/V_{O2}	通道分离	f = 1 kHz 至 20kHz				120		dB
输入电压范围								
V_{CM}	共模电压范围	V_S=5 V 至 30 V	LM358		(V –)		(V+) – 1.5	V
		V_S = 30 V	LM358A					
		V_S=5 V 至 30 V	LM358	T_A = 0°C 至 70°C	(V –)		(V+) – 2	
		V_S = 30 V	LM358A					
CMRR	共模抑制比	V_S = 5V 至 30V；V_{CM} = 0V			65	80		dB
输入偏置电流								
I_B	输入偏置电流	V_O = 1.4V	LM358			-20	-250	nA
				T_A = 0°C 至 70°C			– 500	
			LM358A			– 15	– 100	
				T_A = 0°C 至 70°C			– 200	
I_{OS}	输入失调电流	V_O = 1.4V	LM358			2	50	nA
				T_A = 0°C 至 70°C			150	
			LM358A			2	30	
				T_A = 0°C 至 70°C			75	
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移					10		pA/°C
			LM358A	T_A = 0°C 至 70°C			300	
噪声								
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz				40		nV/$\sqrt{Hz}$
开环增益								
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V；V_O = 1V 至 11V；R_L ≥ 2kΩ			25	100		V/mV
				T_A = 0°C 至 70°C	15			
频率响应								
GBW	增益带宽积					0.7		MHz
SR	压摆率	G = +1				0.3		V/μs
输出								
V_O	自电源轨的电压输出摆幅	正电源轨	V_S = 30V；R_L = 2kΩ	T_A = 0°C 至 70°C			4	V
			V_S = 30V；R_L ≥ 10kΩ			2	3	
			V_S = 5V；R_L ≥ 2kΩ				1.5	
		负电源轨	V_S = 5V；R_L ≤ 10kΩ	T_A = 0°C 至 70°C		5	20	mV
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = 0V；V_{ID} = 1V	吸电流		-20	– 30		mA
				LM358A			– 60	
				T_A = 0°C 至 70°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = 15V；V_{ID} = – 1V	灌电流		10	20		
				T_A = 0°C 至 70°C	5			
		V_{ID} = – 1V；V_O = 200mV			12	30		μA
I_{SC}	短路电流	V_S = 10V；V_O = V_S / 2				±40	±60	mA
电源								

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.7 电气特性：LM358、LM358A（续）

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下测得（除非另有说明）

参数		测试条件(1)		最小值	典型值(2)	最大值	单位
I_Q	每个放大器的静态电流	V_O = 2.5V；I_O = 0A	T_A = 0°C 至 70°C		350	600	μA
		V_S = 30V；V_O = 15V；I_O = 0A			500	1000	

(1) 除非另有说明，所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM358 和 LM358A，用于测试目的的最大 V_S 为 30V。
(2) 所有典型值均在 T_A=25°C 下测得。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.8 电气特性：LM2904、LM2904V

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下测得（除非另有说明）

参数		测试条件(1)				最小值	典型值(2)	最大值	单位
失调电压									
V_{OS}	输入失调电压	V_S = 5V 至最大值；V_{CM} = 0V；V_O = 1.4V	不带后缀 A 的器件				3	7	mV
					T_A = -40°C 至 125°C			10	
			A 后缀器件				1	2	
					T_A = -40°C 至 125°C			4	
dV_{OS}/d_T	输入失调电压温漂				T_A = -40°C 至 125°C		7		µV/°C
PSRR	输入失调电压与电源电压间的关系（$\Delta V_{IO}/\Delta V_S$）	V_S = 5V 至 30V				65	100		dB
V_{O1}/V_{O2}	通道隔离	f = 1kHz 至 20kHz					120		dB
输入电压范围									
V_{CM}	共模电压范围	V_S = 5V 至最大值				(V –)		(V+) – 1.5	V
					T_A = -40°C 至 125°C	(V –)		(V+) – 2	
CMRR	共模抑制比	V_S = 5V 至最大值；V_{CM} = 0V				65	80		dB
输入偏置电流									
I_B	输入偏置电流	V_O = 1.4V					-20	-250	nA
					T_A = -40°C 至 125°C			-500	
I_{OS}	输入失调电流	V_O = 1.4V	不带后缀 V 的器件				2	50	nA
					T_A = -40°C 至 125°C			300	
			带有 V 后缀的器件				2	50	
					T_A = -40°C 至 125°C			150	
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移				T_A = -40°C 至 125°C		10		pA/°C
噪声									
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz					40		nV/√Hz
开环增益									
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V；V_O = 1V 至 11V；R_L ≥ 2kΩ				25	100		V/mV
					T_A = -40°C 至 125°C	15			
频率响应									
GBW	增益带宽积						0.7		MHz
SR	压摆率	G = +1					0.3		V/µs
输出									
V_O	相对于电源轨的电压输出摆幅	正电源轨	R_L ≥ 10kΩ			V_S - 1.5			V
			不带后缀 V 的器件	V_S = 最大值；R_L = 2kΩ	T_A = -40°C 至 125°C			4	
				V_S = 最大值；R_L ≥ 10kΩ			2	3	
			带有 V 后缀的器件	V_S = 最大值；R_L = 2kΩ				6	
				V_S = 最大值；R_L ≥ 10kΩ			4	5	
		负电源轨		V_S = 5V；R_L ≤ 10kΩ	T_A = -40°C 至 125°C		5	20	mV
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = 0V；V_{ID} = 1V		拉电流		-20	-30		mA
					T_A = -40°C 至 125°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = 15V；V_{ID} = -1V		灌电流		10	20		
					T_A = -40°C 至 125°C	5			
		V_{ID} = – 1V；V_O = 200mV		不带后缀 V 的器件			30		µA
				带有 V 后缀的器件		12	40		
I_{SC}	短路电流	V_S = 10V；V_O = V_S/2					±40	±60	mA
电源									
I_Q	每个放大器的静态电流	V_O = 2.5V；I_O = 0A			T_A = -40°C 至 125°C		350	600	µA
		V_S = 最大值；V_O = 最大值/2；I_O = 0A					500	1000	

(1) 除非另有说明，否则所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM2904，用于测试目的的最大 V_S 为 26V，对于 LM2904V 则为 32V。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

(2) 所有典型值均在 T_A=25°C 下测得。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.9 电气特性：LM158、LM158A

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下测得（除非另有说明）

参数		测试条件(1)				最小值	典型值(2)	最大值	单位
失调电压									
V_{OS}	输入失调电压	V_S = 5V 至 30V；$V_{C\ M}$ = 0V；V_O = 1.4V		LM158			3	5	mV
					T_A = -55°C 至 125°C			7	
				LM158A				2	
					T_A = -55°C 至 125°C			4	
dV_{OS}/d_T	输入失调电压漂移			LM158	T_A = -55°C 至 125°C		7		μV/°C
				LM158A	T_A = -55°C 至 125°C		7	15(3)	
PSRR	输入失调电压与电源电压间的关系 ($\Delta V_{IO}/\Delta V_S$)	V_S=5 V 至 30 V				65	100		dB
V_{O1}/V_{O2}	通道分离	f = 1 kHz 至 20kHz					120		dB
输入电压范围									
V_{CM}	共模电压范围	V_S=5 V 至 30 V		LM158		(V –)		(V+) – 1.5	V
		V_S = 30 V		LM158A					
		V_S=5 V 至 30 V		LM158	T_A = -55°C 至 125°C	(V –)		(V+) – 2	
		V_S = 30 V		LM158A					
CMRR	共模抑制比	V_S = 5V 至 30V；V_{CM} = 0V				70	80		dB
输入偏置电流									
I_B	输入偏置电流	V_O = 1.4V		LM158			-20	– 150	nA
					T_A = -55°C 至 125°C			– 300	
				LM158A			– 15	-50	
					T_A = -55°C 至 125°C			– 100	
I_{OS}	输入失调电流	V_O = 1.4V		LM158			2	30	nA
					T_A = -55°C 至 125°C			100	
				LM158A			2	10	
					T_A = -55°C 至 125°C			30	
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移						10		pA/°C
				LM158A	T_A = -55°C 至 125°C			200	
噪声									
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz					40		nV/√Hz
开环增益									
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V；V_O = 1V 至 11V；R_L ≥ 2kΩ				50	100		V/mV
					T_A = -55°C 至 125°C	25			
频率响应									
GBW	增益带宽积						0.7		MHz
SR	压摆率	G = +1					0.3		V/μs
输出									
V_O	自电源轨的电压输出摆幅	正电源轨	V_S = 30V；R_L = 2kΩ		T_A = -55°C 至 125°C			4	V
			V_S = 30V；R_L ≥ 10kΩ				2	3	
			V_S = 5V；R_L ≥ 2kΩ					1.5	
		负电源轨	V_S = 5V；R_L ≤ 10kΩ		T_A = -55°C 至 125°C		5	20	mV
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = 0V；V_{ID} = 1V	吸电流			-20	– 30		mA
				LM158A				– 60	
					T_A = -55°C 至 125°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = 15V；V_{ID} = – 1V	灌电流			10	20		
					T_A = -55°C 至 125°C	5			
		V_{ID} = – 1V；V_O = 200mV				12	30		μA
I_{SC}	短路电流	V_S = 10V；V_O = V_S / 2					±40	±60	mA

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.9 电气特性：LM158、LM158A（续）

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下测得（除非另有说明）

参数		测试条件(1)		最小值	典型值(2)	最大值	单位
电源							
I_Q	每个放大器的静态电流	V_O = 2.5V；I_O = 0A	T_A = -55°C 至 125°C		350	600	μA
		V_S = 30V；V_O = 15V；I_O = 0A			500	1000	

(1) 除非另有说明，所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM158 和 LM158A，用于测试目的的最大 V_S 为 30V。
(2) 所有典型值均在 T_A=25°C 下测得。
(3) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品，此参数未经量产测试。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.10 电气特性：LM258、LM258A

在 V_S = (V+) – (V –) = 5V，T_A = 25°C 条件下（除非另有说明）

参数		测试条件(1)				最小值	典型值(2)	最大值	单位
失调电压									
V_{OS}	输入失调电压	V_S = 5V 至 30V；$V_{C\ M}$ = 0V；V_O = 1.4V	LM258				3	5	mV
					T_A = -25°C 至 85°C			7	
			LM258A				2	3	
					T_A = -25°C 至 85°C			4	
dV_{OS}/d_T	输入失调电压漂移		LM258		T_A = -25°C 至 85°C		7		μV/°C
			LM258A				7	15	
PSRR	输入失调电压与电源电压间的关系 ($\Delta V_{IO}/\Delta V_S$)	V_S=5 V 至 30 V				65	100		dB
V_{O1}/V_{O2}	通道分离	f = 1 kHz 至 20kHz					120		dB
输入电压范围									
V_{CM}	共模电压范围	V_S=5 V 至 30 V	LM258			(V –)		(V+) – 1.5	V
		V_S = 30 V	LM258A						
		V_S=5 V 至 30 V	LM258		T_A = -25°C 至 85°C	(V –)		(V+) – 2	
		V_S = 30 V	LM258A						
CMRR	共模抑制比	V_S = 5V 至 30V；V_{CM} = 0V				70	80		dB
输入偏置电流									
I_B	输入偏置电流	V_O = 1.4V	LM258				-20	– 150	nA
					T_A = -25°C 至 85°C			– 300	
			LM258A				– 15	-80	
					T_A = -25°C 至 85°C			– 100	
I_{OS}	输入失调电流	V_O = 1.4V	LM258				2	30	nA
					T_A = -25°C 至 85°C			100	
			LM258A				2	15	
					T_A = -25°C 至 85°C			30	
dI_{OS}/d_T	输入失调电流漂移						10		pA/°C
			LM258A		T_A = -25°C 至 85°C			200	
噪声									
e_n	输入电压噪声密度	f = 1kHz					40		nV/√Hz
开环增益									
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 15V；V_O = 1V 至 11V；R_L ≥ 2kΩ				50	100		V/mV
					T_A = -25°C 至 85°C	25			
频率响应									
GBW	增益带宽积						0.7		MHz
SR	压摆率	G = +1					0.3		V/μs
输出									
V_O	自电源轨的电压输出摆幅	正电源轨	V_S = 30V；R_L = 2kΩ		T_A = -25°C 至 85°C			4	V
			V_S = 30V；R_L ≥ 10kΩ				2	3	
			V_S = 5V；R_L ≥ 2kΩ					1.5	
		负电源轨	V_S = 5V；R_L ≤ 10kΩ		T_A = -25°C 至 85°C		5	20	mV
I_O	输出电流	V_S = 15V；V_O = 0V；V_{ID} = 1V	吸电流			-20	– 30		mA
				LM258A				– 60	
					T_A = -25°C 至 85°C	-10			
		V_S = 15V；V_O = 15V；V_{ID} = – 1V	灌电流			10	20		
					T_A = -25°C 至 85°C	5			
		V_{ID} = – 1V；V_O = 200mV				12	30		μA
I_{SC}	短路电流	V_S = 10V；V_O = V_S / 2					±40	±60	mA
电源									
I_Q	每个放大器的静态电流	V_O = 2.5V；I_O = 0A			T_A = -25°C 至 85°C		350	600	μA
		V_S = 30V；V_O = 15V；I_O = 0A					500	1000	

(1) 除非另有说明，所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。对于 LM258 和 LM258A，用于测试目的的最大 V_S 为 30V。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

(2) 所有典型值均在 T_A=25°C 下测得。

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。

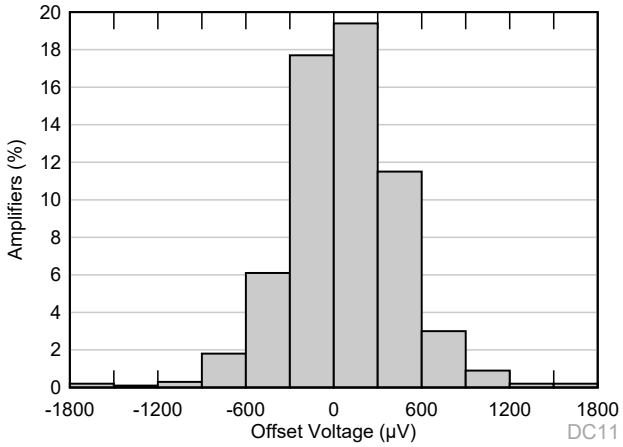


图 5-1. 失调电压生产分配

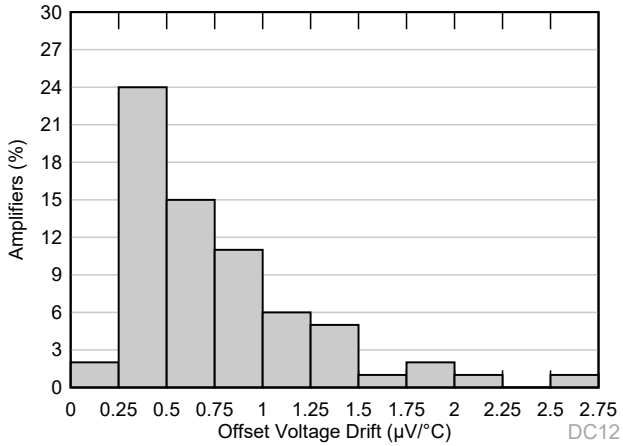


图 5-2. 失调电压漂移分配

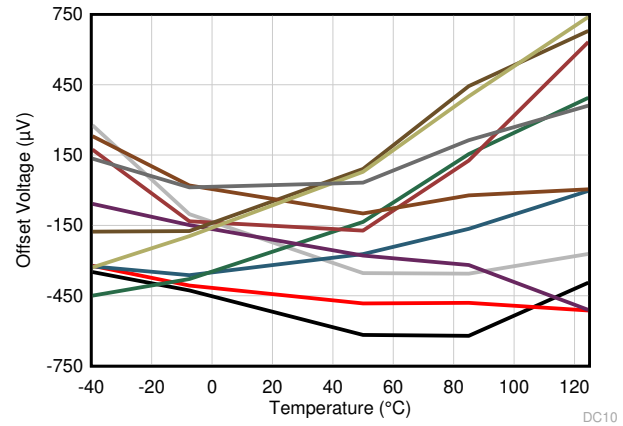


图 5-3. 失调电压与温度间的关系

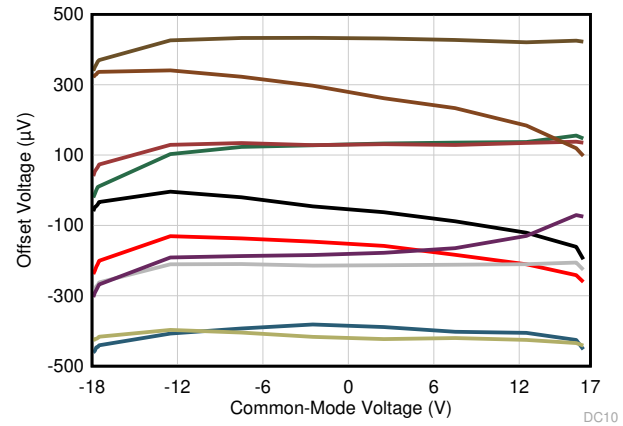


图 5-4. 失调电压与共模电压间的关系

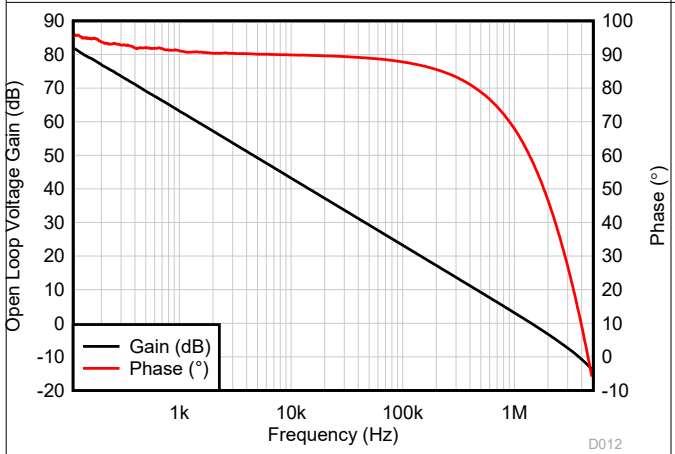


图 5-5. 开环增益和相位与频率间的关系

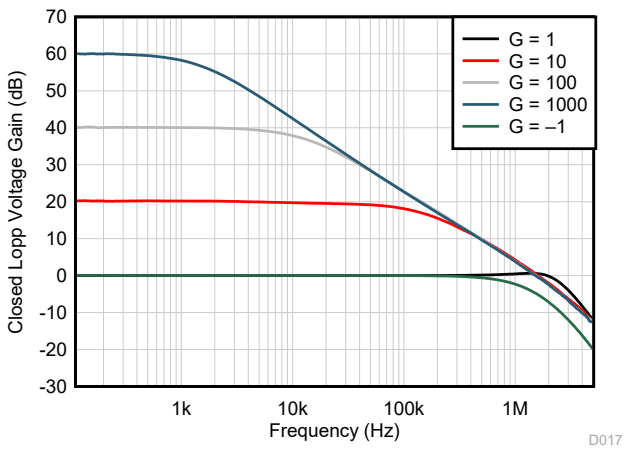


图 5-6. 闭环增益与频率间的关系

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。

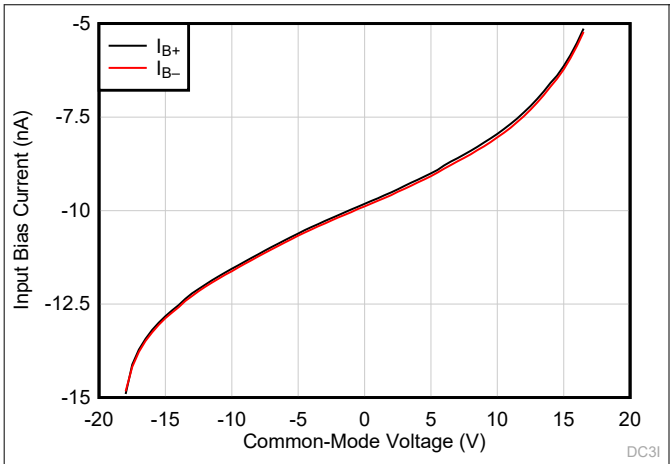


图 5-7. 输入偏置电流与共模电压间的关系

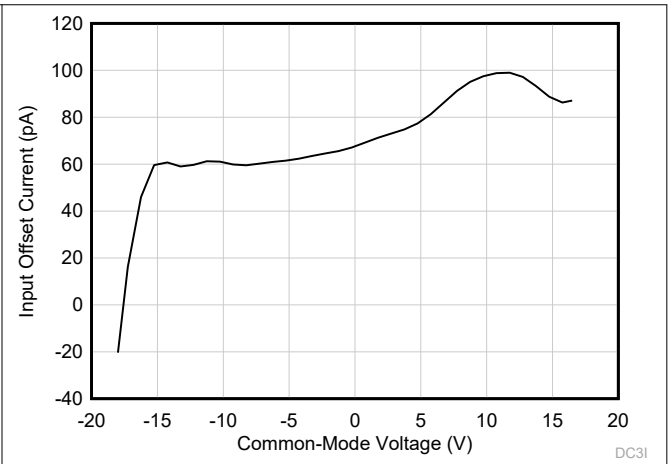


图 5-8. 输入失调电流与共模电压间的关系

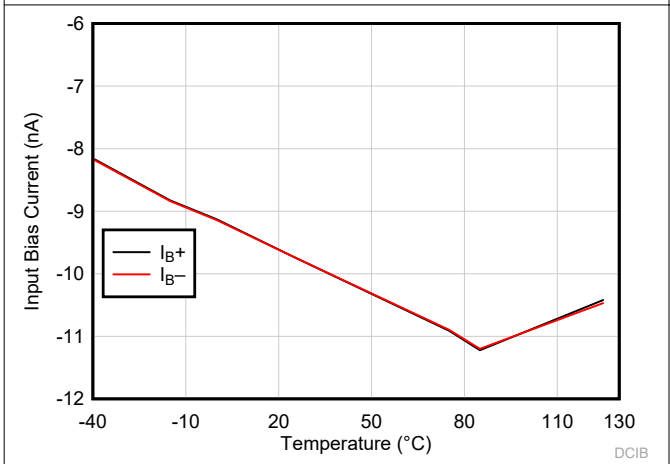


图 5-9. 输入偏置电流与温度间的关系

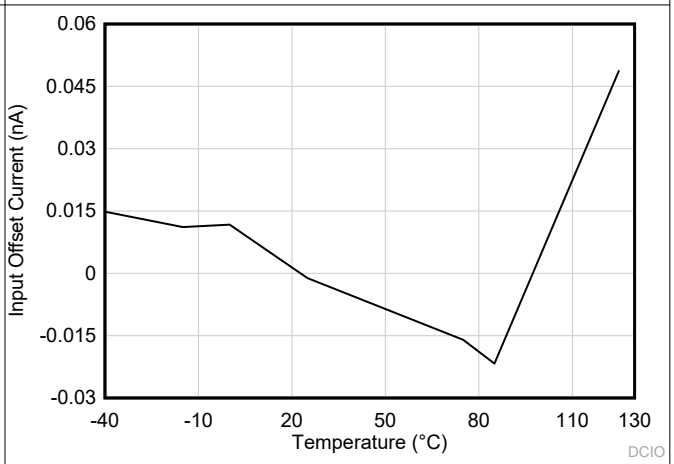


图 5-10. 输入失调电流与温度间的关系

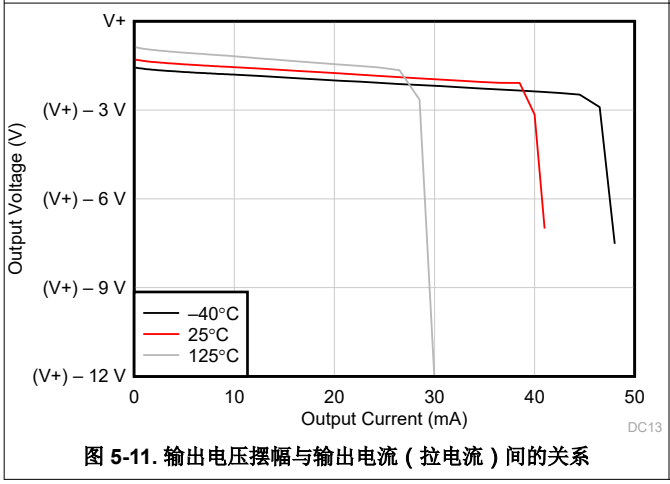


图 5-11. 输出电压摆幅与输出电流（拉电流）间的关系

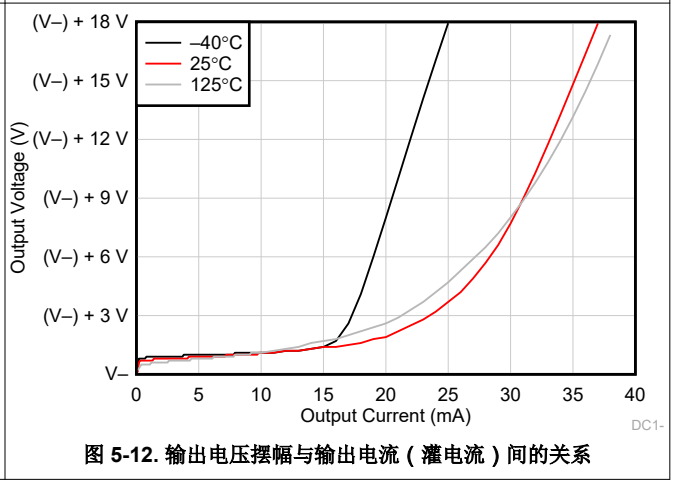


图 5-12. 输出电压摆幅与输出电流（灌电流）间的关系

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。

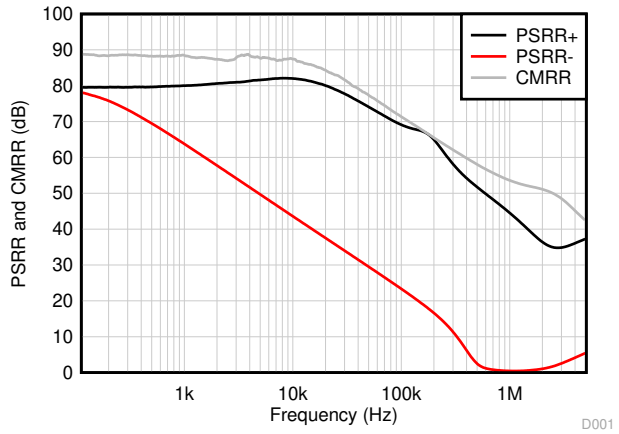


图 5-13. CMRR 和 PSRR 与频率间的关系

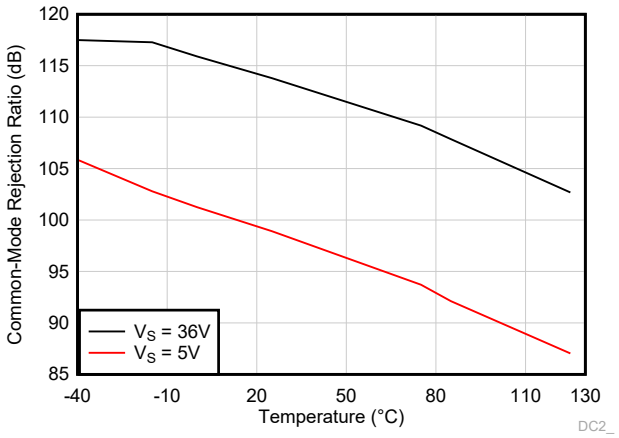
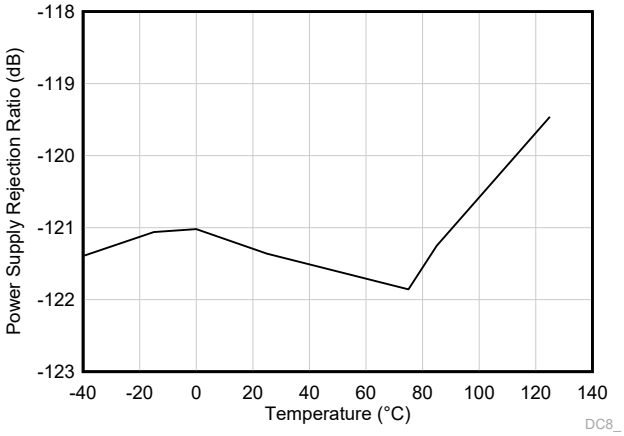


图 5-14. 共模抑制比与温度间的关系 (dB)



V_S=5 V 至 36 V

图 5-15. 电源抑制比与温度间的关系 (dB)

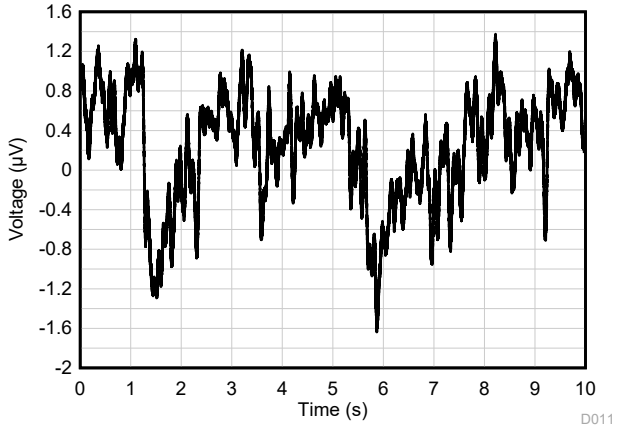


图 5-16. 0.1Hz 至 10Hz 噪声

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。

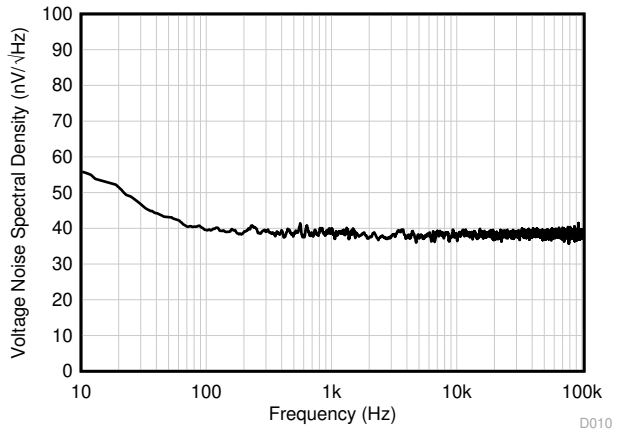
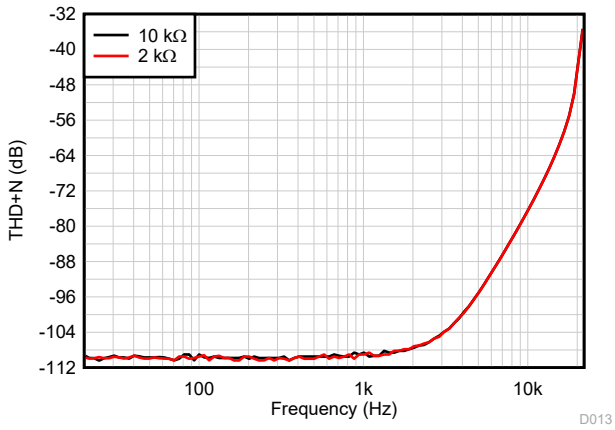
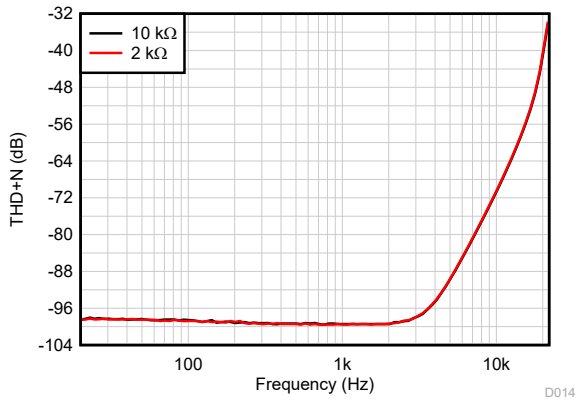


图 5-17. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系



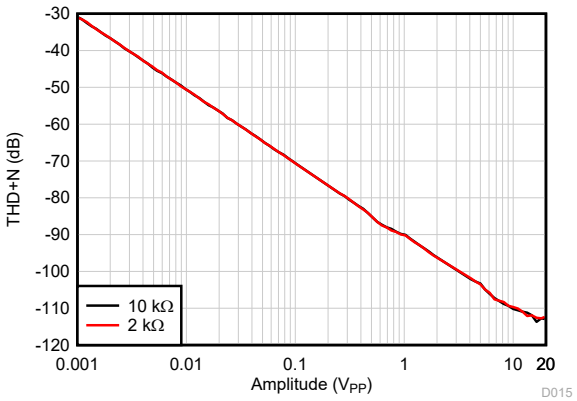
G = 1，f = 1kHz，BW = 80kHz，
V_{OUT} = 10V_{PP}，R_L 连接到 V－

图 5-18. THD+N 比与频率间的关系，G = 1



G = －1，f = 1kHz，BW = 80kHz，
V_{OUT} = 10V_{PP}，R_L 连接到 V－
请参阅图 6-3

图 5-19. THD+N 比与频率间的关系，G = -1



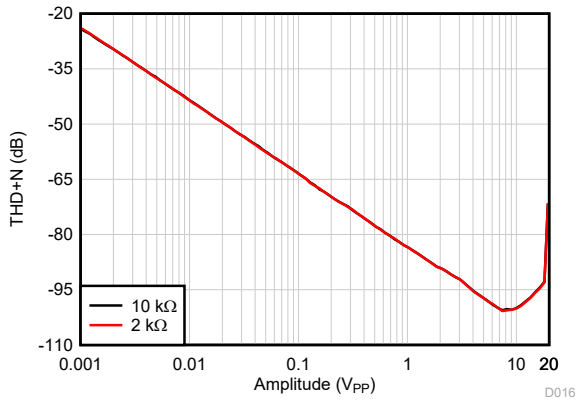
G = 1，f = 1kHz，BW = 80kHz，
R_L（连接到 V－）

图 5-20. THD+N 比与输出振幅间的关系，G = 1

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。



G = –1，f = 1kHz，BW = 80kHz，
R_L（连接到 V–）
请参阅图 6-3

图 5-21. THD+N 比与输出振幅间的关系，G = –1

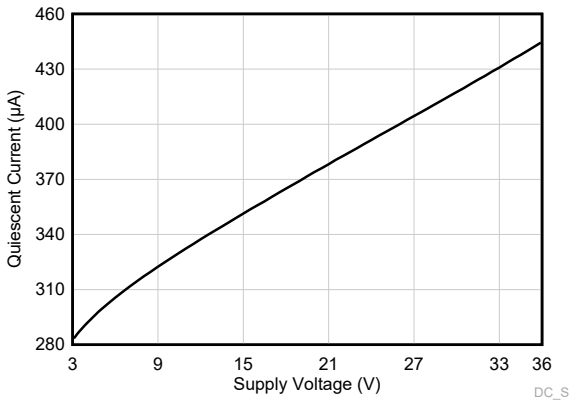


图 5-22. 静态电流与电源电压间的关系

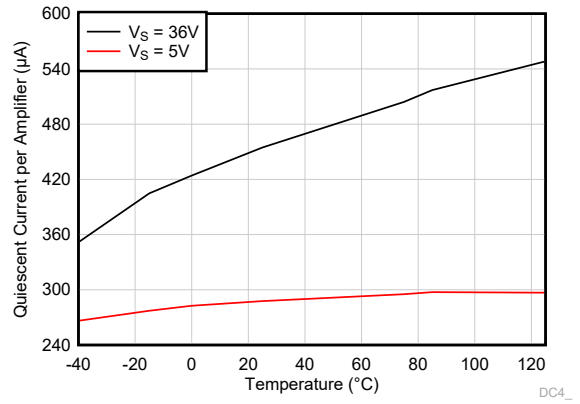


图 5-23. 静态电流与温度间的关系

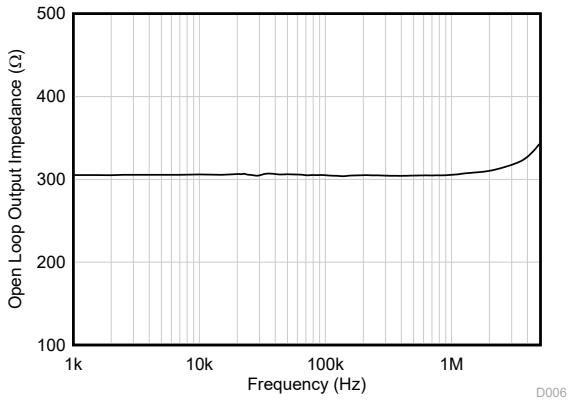
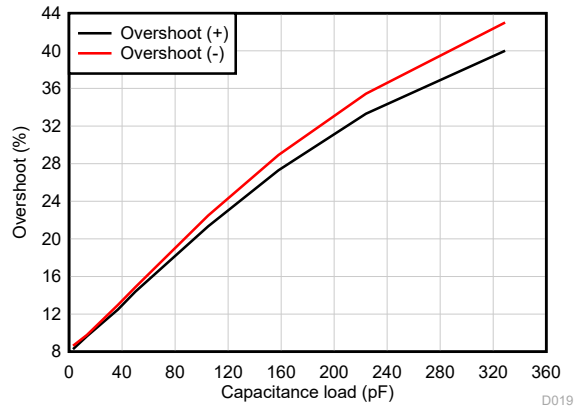
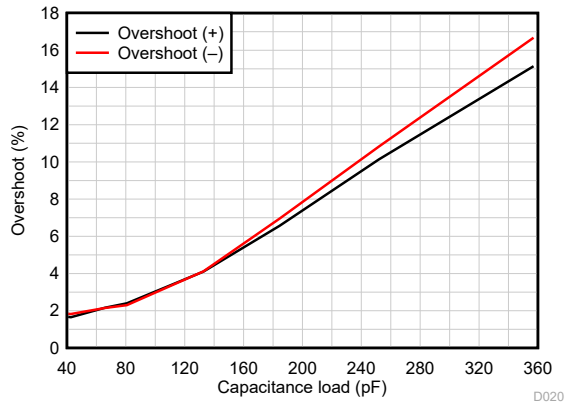


图 5-24. 开环输出阻抗与频率间的关系



G = 1，100mV 输出阶跃，R_L = 开路

图 5-25. 小信号过冲与容性负载间的关系



G = –1，100mV 输出阶跃，R_L = 开路

图 5-26. 小信号过冲与容性负载间的关系

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。

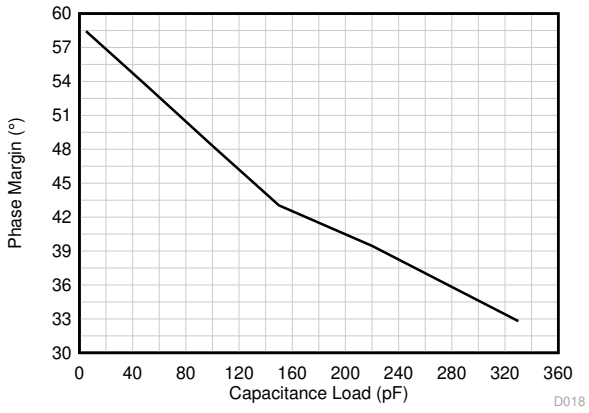
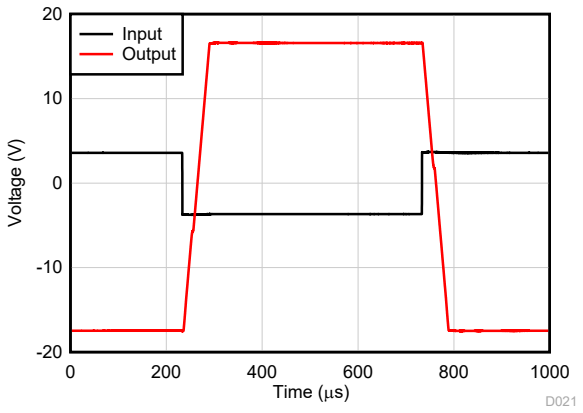
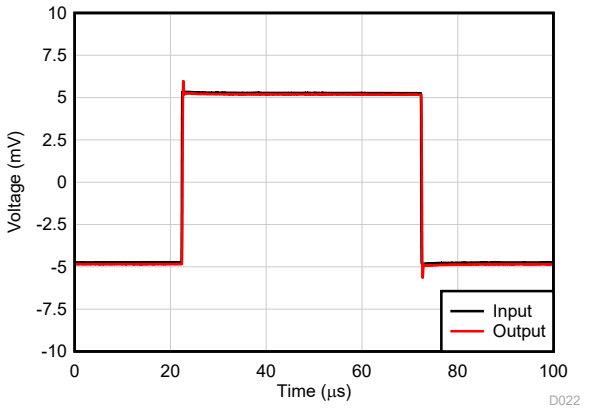


图 5-27. 相位裕度与容性负载间的关系



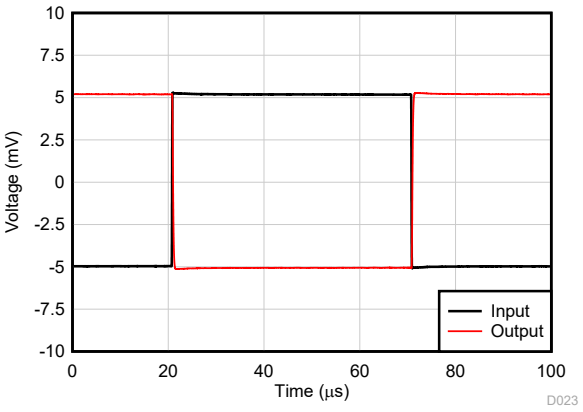
G = -10

图 5-28. 过载恢复



G = 1，R_L = 开路

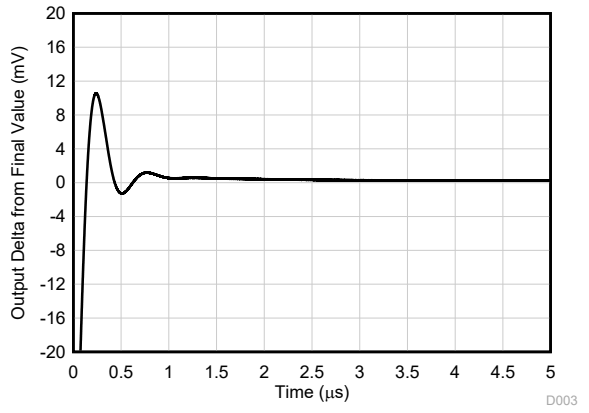
图 5-29. 小信号阶跃响应，G = 1



G = －1，R_L = 开路，R_{FB} = 10KΩ

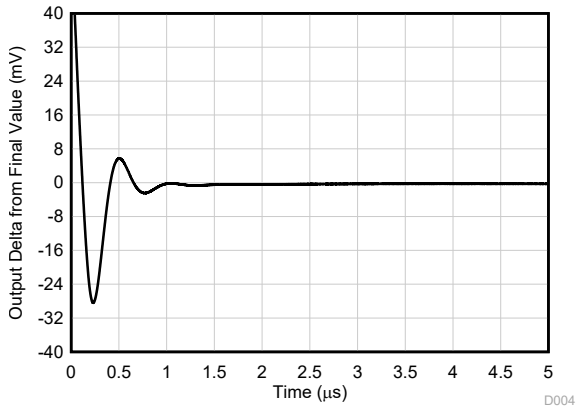
请参阅图 6-3

图 5-30. 小信号阶跃响应，G = －1



G = 1，R_L = 开路

图 5-31. 大信号阶跃响应（上升）



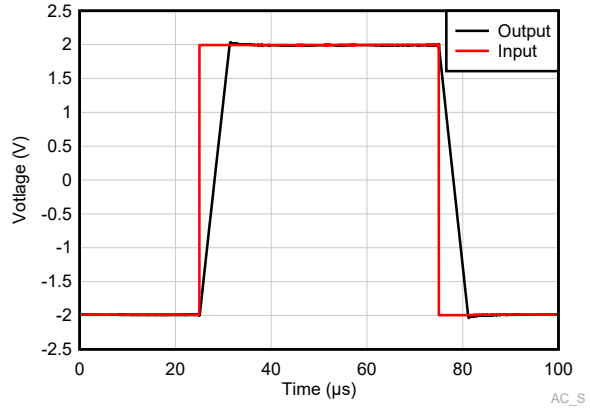
G = 1，R_L = 开路

图 5-32. 大信号阶跃响应（下降）

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.11 典型特性：LM358B 和 LM2904B （续）

这个典型特性部分适用于 LM358B 和 LM2904B。此部分中的典型特性数据均在 T_A = 25°C、V_S = 36V (±18V)、V_{CM} = V_S / 2、R_{LOAD} = 10kΩ（连接到 V_S / 2）条件下获得（除非另有说明）。



G = 1，R_L = 开路

图 5-33. 大信号阶跃响应

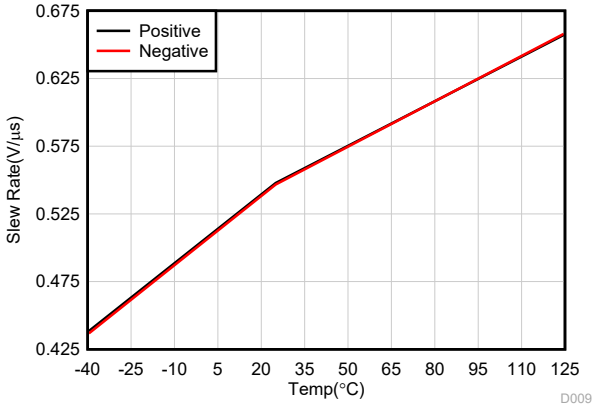


图 5-34. 压摆率与温度间的关系

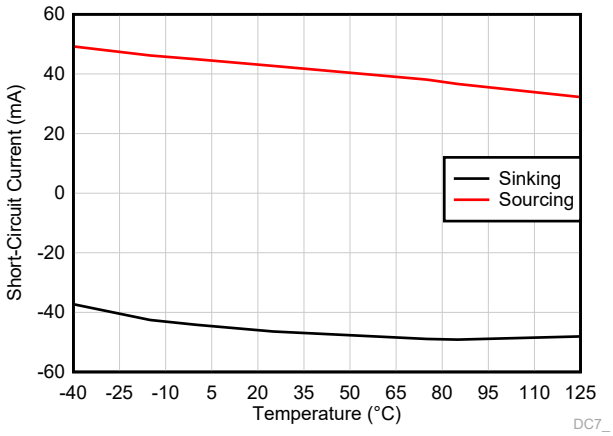
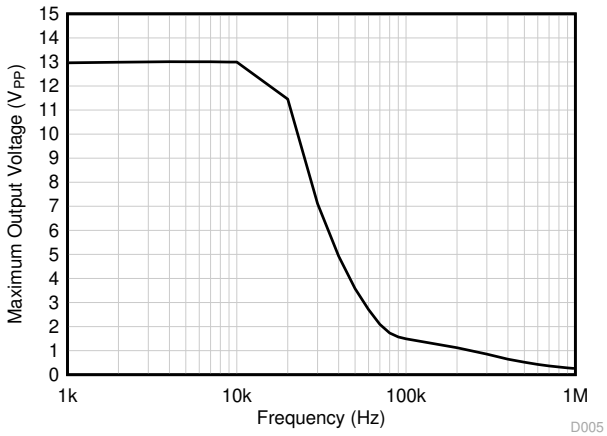


图 5-35. 短路电流与温度间的关系



V_S = 15 V

图 5-36. 最大输出电压与频率间的关系

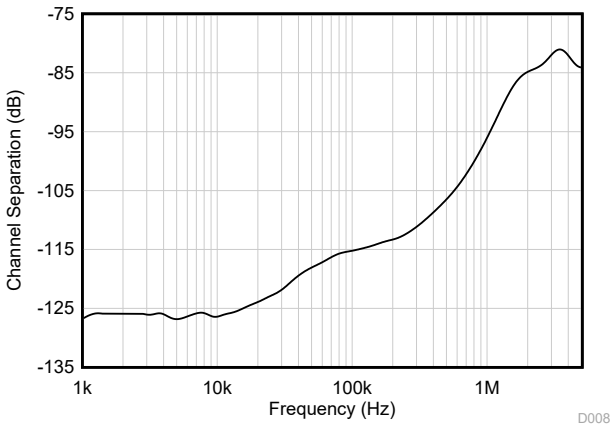


图 5-37. 通道隔离与频率间的关系

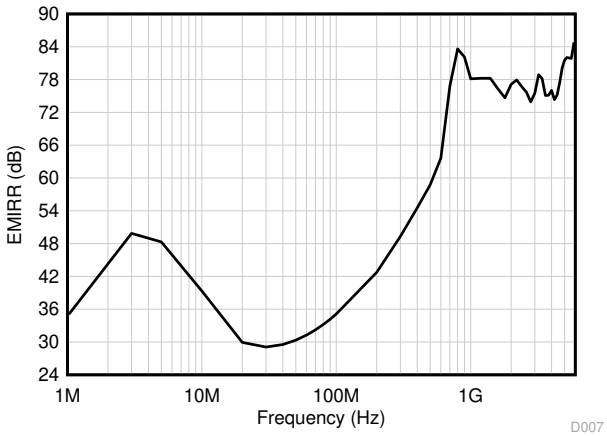


图 5-38. EMIRR（电磁干扰抑制比）与频率间的关系

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.12 典型特性：LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V

该典型特性部分适用于 LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V。

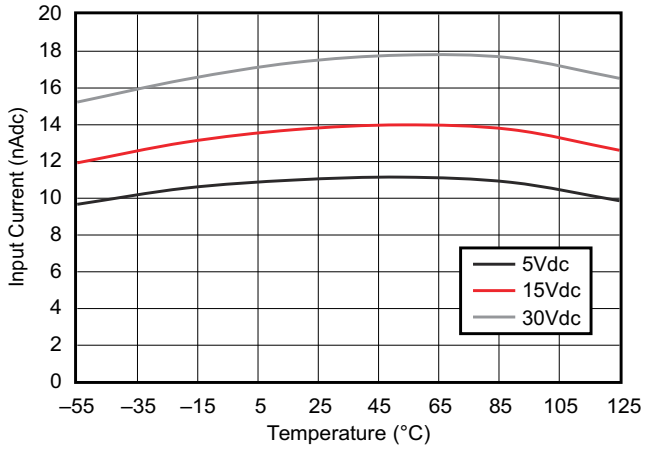


图 5-39. 输入电流与温度间的关系

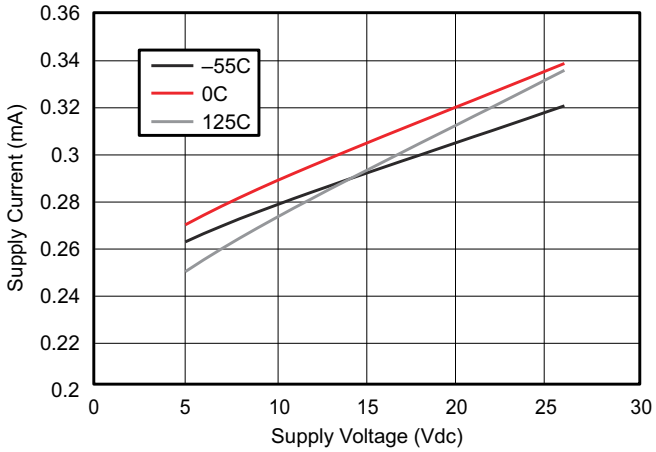


图 5-40. 电源电流与电源电压间的关系

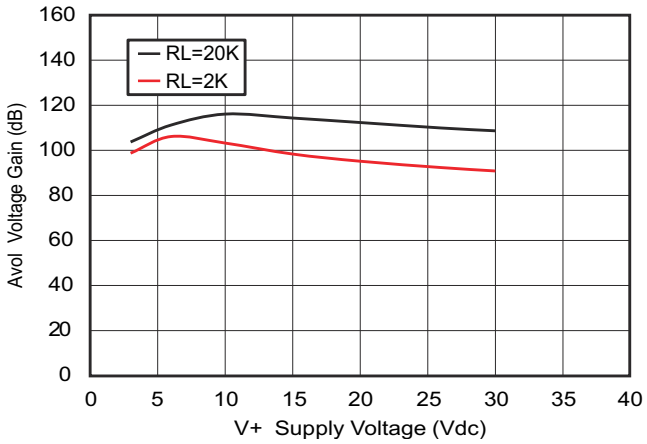


图 5-41. 电压增益与电源电压间的关系

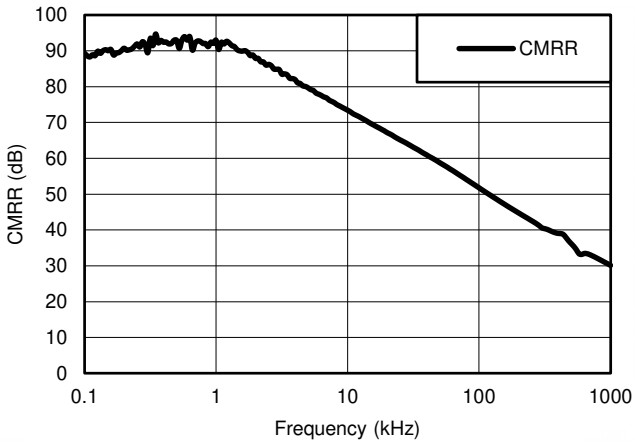


图 5-42. 共模抑制比与频率间的关系

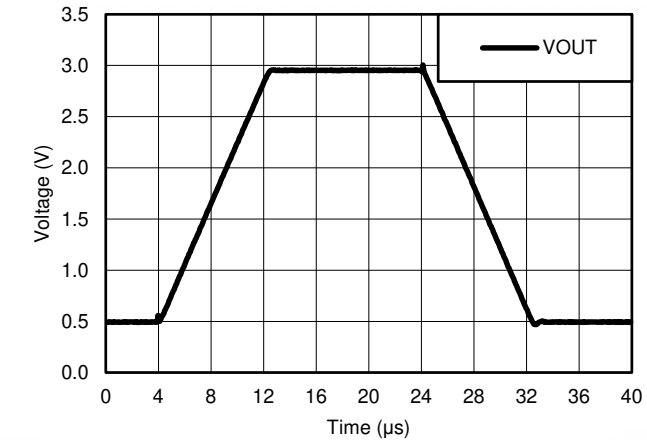


图 5-43. 电压跟随器大信号脉冲响应 (50pF)

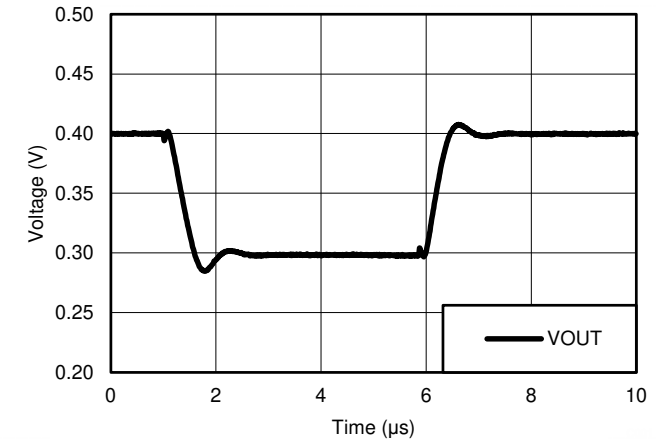


图 5-44. 电压跟随器小信号响应 (50pF)

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.12 典型特性：LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V（续）

该典型特性部分适用于 LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V。

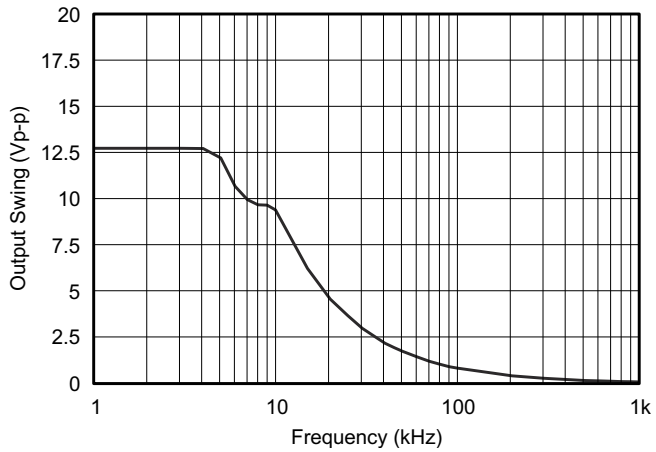


图 5-45. 最大输出摆幅与频率间的关系 (V_{CC} = 15V)

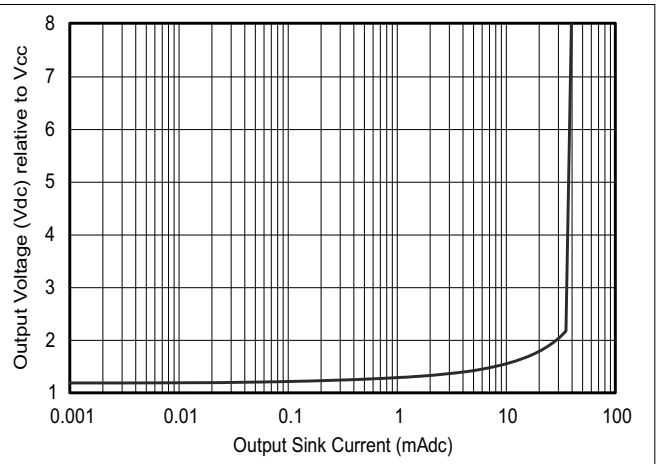


图 5-46. 输出拉电流特性

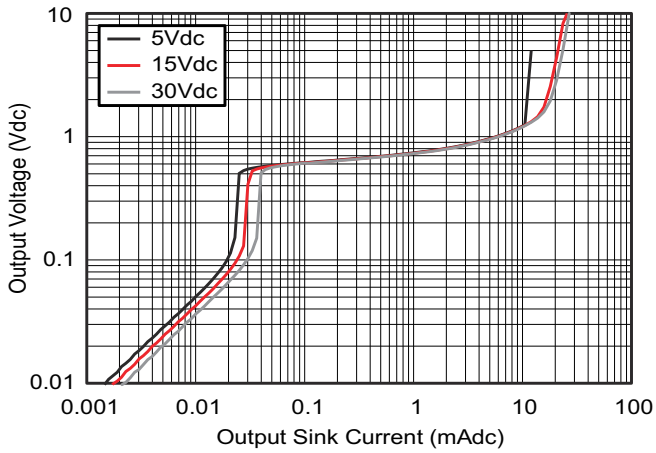


图 5-47. 输出灌电流特性

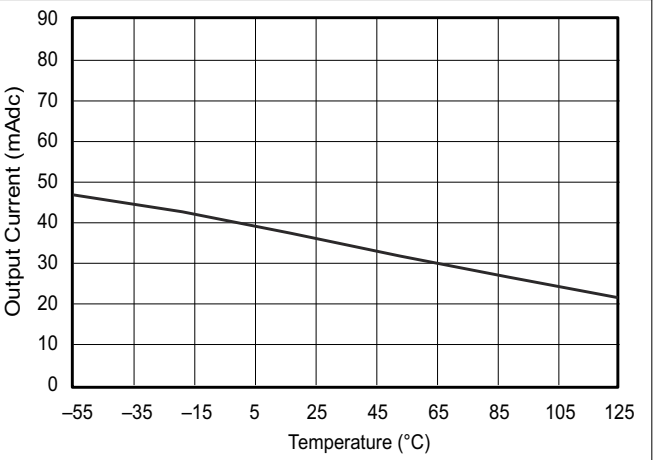


图 5-48. 拉电流限制

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

6 参数测量信息

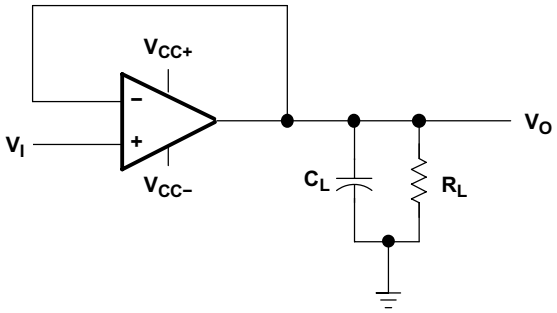


图 6-1. 单位增益放大器

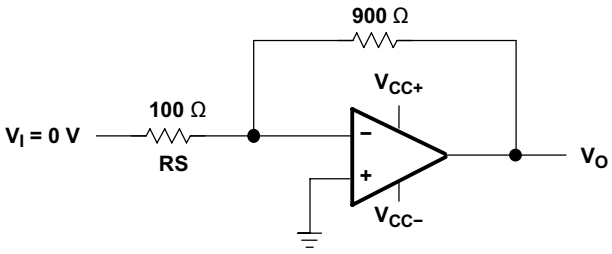


图 6-2. 噪声测试电路

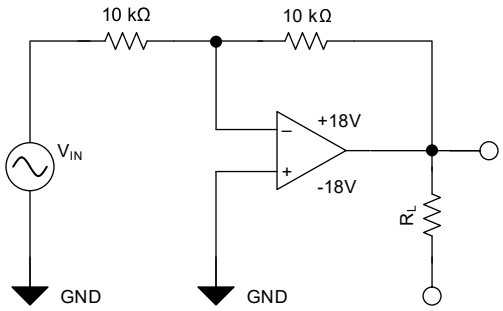


图 6-3. THD+N 和小信号阶跃响应的测试电路 (G = –1)

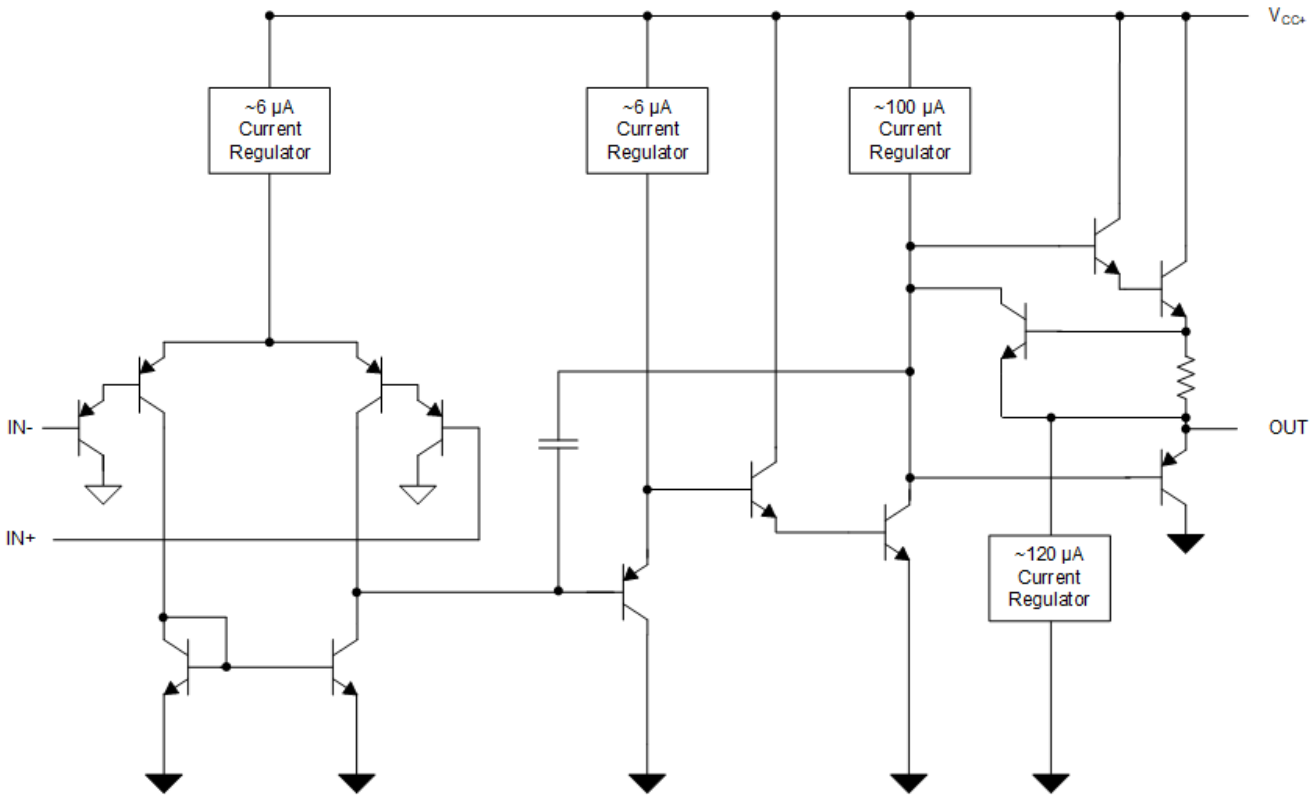
7 详细说明

7.1 概述

这些器件包含 2 个独立的高增益频率补偿运算放大器，专为在宽电压范围内使用单电源而设计。如果两个电源之间的电压差在*建议运行条件*中规定的电源电压范围内且 V_S 比输入共模电压至少高 1.5V，也可使用双电源供电运行。低电源电流消耗与电源电压的幅度无关。

具体应用包括传感器放大器、直流放大块和所有传统运算放大器电路，现在均可在单电源电压系统中轻松实施。例如，这些器件可直接由数字系统使用的标准 5V 电源供电，无需额外的 ±5V 电源即可轻松提供所需的接口电子元件。

7.2 功能方框图：LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA



Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

7.3 特性说明

7.3.1 单位增益带宽

单位增益带宽是具有单位增益的放大器可以工作而不会导致信号严重失真的最大频率。这些器件具有 1.2MHz 的单位增益带宽（B 版本）。

7.3.2 压摆率

压摆率是运算放大器在输入发生变化时可以改变输出的速率。这些器件具有 0.5V/μs 的压摆率（B 版本）。

7.3.3 输入共模范围

有效的共模范围是从器件地到 V_S – 1.5V（在整个温度范围内为 V_S – 2V）。输入可能会超过 V_S 直至最大 V_S 而不会损坏器件。至少一个输入必须在有效的输入共模范围内，才能使输出具有正确的相位。如果两个输入都超出有效范围，则输出相位未定义。如果任一输入低于 V– 超过 0.3V，则输入电流应限制为 1mA，并且输出相位未定义。

7.4 器件功能模式

这些器件会在连接电源时加电。该器件可根据应用情况作为单电源运算放大器或双电源放大器使用。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

8 应用和实现

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 组件规范，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计实现，以确认系统功能。

8.1 应用信息

LMx58 和 LM2904 运算放大器适用于各种信号调节应用。可以在 V_S 之前为输入供电，从而实现多电源电路的灵活性。

8.2 典型应用

运算放大器的典型应用是反相放大器。该放大器在输入端接受正电压，然后使电压变为同样幅度的负电压。它还会以相同的方式使负输入电压变为正电压。

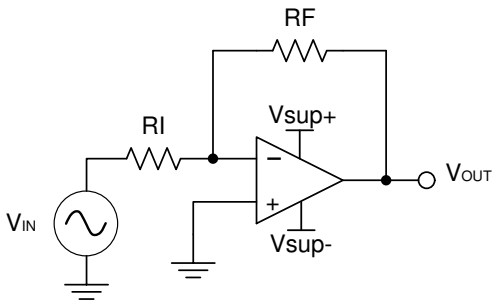


图 8-1. 应用原理图

8.2.1 设计要求

选择的电源电压必须大于输入电压范围和输出范围。例如，此应用将 ±0.5V 的信号扩展到了 ±1.8V。将电源设置在 ±12V 就足以满足此应用的要求。

8.2.2 详细设计过程

使用 方程式 1 和 方程式 2 来确定反相放大器需要的增益：

$$A_V = \frac{VOUT}{VIN} \tag{1}$$

$$A_V = \frac{1.8}{-0.5} = -3.6 \tag{2}$$

确定所需增益后，选择 R_I 或 R_F 的阻值。[下标也应该固定在相应数字和公式上。]由于放大器电路使用毫安级电流，因此通常需要选择千欧姆级阻值。这样可以确保该器件不会消耗过多电流。此示例使用的 R_I 为 10kΩ，这意味着对 R_F 使用 36kΩ。这是由方程式 3 算出的。

$$A_V = -\frac{RF}{RI} \tag{3}$$

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

8.2.3 应用曲线

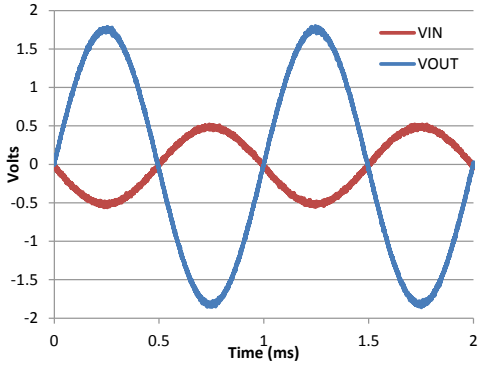


图 8-2. 反相放大器的输入和输出电压

8.3 电源相关建议

小心

大于建议额定工作范围的电源电压可能会使器件永久损坏（请参阅*绝对最大额定值*）。

将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近，以减少从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息，请参阅节 8.4。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

为了实现器件的更高工作性能，应使用良好的 PCB 布局实践，包括：

- 噪声可通过全部电路电源引脚以及运算放大器自身传入模拟电路。旁路电容用于通过为局部模拟电路提供低阻抗电源，以降低耦合噪声。
  - 在每个电源引脚和接地端之间接入低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容，并尽量靠近器件放置。针对单电源应用，V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地层有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流。
- 为了减少寄生耦合，应让输入布线尽可能远离电源或输出布线。如果这些迹线不能保持分离状态，最好让敏感走线与有噪声的走线垂直相交，而不是平行相交。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。使 R_F 和 R_G 接近反相输入，可更大限度地减小寄生电容（如*布局示例*所示）。
- 尽可能缩短输入布线的长度。切记，输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

8.4.2 布局示例

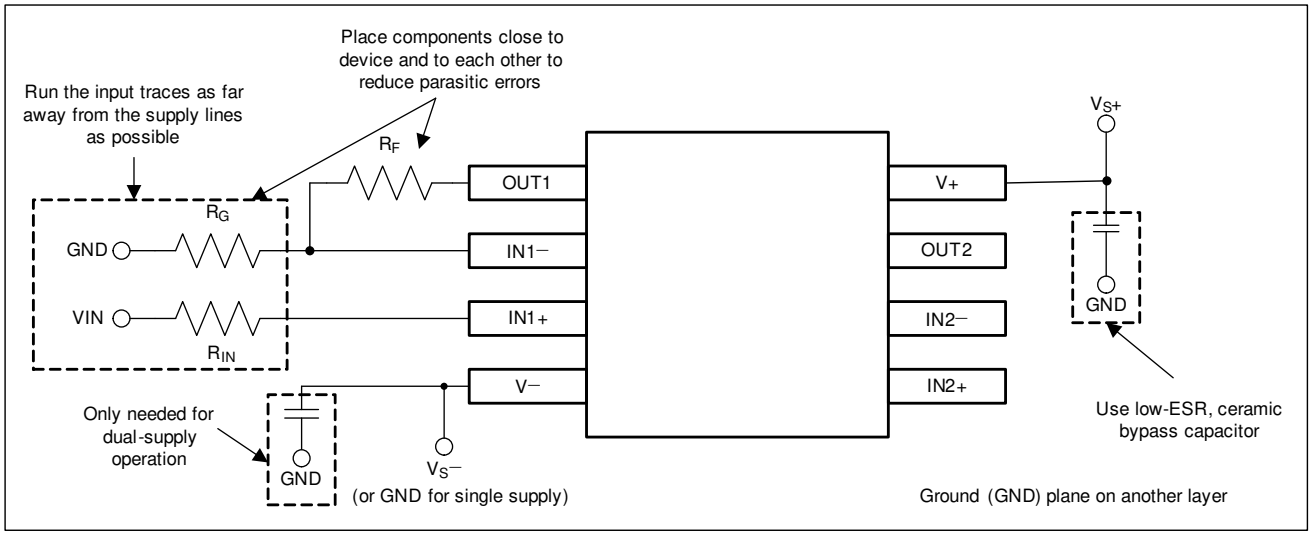


图 8-3. 非反相配置的运算放大器电路板布局

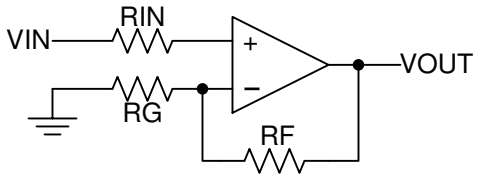


图 8-4. 同相配置的运算放大器原理图

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision AA (March 2022) to Revision AB (October 2024)	Page
• 将*器件信息* 表更改为*封装信息*	1
• 将*电气特性* 部分中 LM358B 和 LM358BA 输入偏置电流值的极性从 ± 更改为 –	6
• 将*电气特性* 部分中 LM2904B 和 LM2904BA 输入偏置电流值的极性从 ± 更改为 –	9

Changes from Revision Z (July 2021) to Revision AA (March 2022)	Page
• 向*器件信息* 表添加了 LM358BA 和 LM2904BA	1
• 向*说明* 部分添加了*系列比较* 表	1
• 在 *ESD 等级* 表中，将 B 版本和 BA 版本的 ESD (CDM) 从 1kV 升高到 1.5kV	4
• 将 LM2904BA 在 T_A = –40℃ 至 +125℃ 范围内的输入失调电压最大值从 ±2.5mV 更改为 ±3.0mV	9

Changes from Revision Y (February 2021) to Revision Z (July 2021)	Page
• 删除了*器件信息* 表中 LM358B 和 LM2904B SOT-23 (8) 封装的预发布标签	1
• 更新了*热性能信息*表中的 DDF (SOT-23) 封装	5
• 从*器件和文档支持*部分删除了*相关链接*	33

Changes from Revision X (June 2020) to Revision Y (February 2021) **Page**

- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式 1
- 在整个数据表中添加了 SOT23-8 (DDF) 封装信息 1
- 删除了*器件信息* 表中 LM358B 和 LM2904B VSSOP (8) 封装的预发布标签 1
- 在*热性能信息*表中添加了 DDF (SOT-23) 封装 5

Changes from Revision W (October 2019) to Revision X (June 2020) **Page**

- 向*应用* 部分添加了应用链接 1
- 删除了*器件信息* 表中 LM358B 和 LM2904B TSSOP (8) 封装的预发布标签 1

Changes from Revision V (September 2018) to Revision W (October 2019) **Page**

- 更改了 *ESD 等级* 中 LM358B 和 LM2904B 的 CDM ESD 等级 4
- 将*建议运行条件*中的 V_S 更改为 V+ 5
- 更改了 LM158FK 和 LM158JG 器件的*热性能信息* 5
- 为 LM358B 和 LM2490B 运算放大器添加了*典型特性*部分 18
- 在*参数测量信息*部分中添加了 THD+N 和小信号阶跃响应的测试电路 (G = –1) 27
- 更改了*功能方框图* 28

Changes from Revision U (January 2017) to Revision V (September 2018) **Page**

- 更改了数据表标题 1
- 更改了*特性* 部分中的前四项 1
- 更改了*应用* 部分中的第一项并添加了四个新项 1
- 更改了*说明* 部分第一段中的电压值 1
- 更改了*说明* 部分第二段中的文本内容 1
- 在数据表中添加了器件 LM358B 和 LM2904B 1
- 更改了*器件信息* 表的前三行，并为状态为预发布的器件添加了交互参考注释 1
- 向*引脚功能*表中添加了表格注释 3
- 将*绝对最大额定值*说明中的“自然通风条件下的温度”更改为“环境温度” 4
- 更改了*绝对最大额定值*表中除 T_J 和 T_{stg} 以外的所有条目 4
- 从*绝对最大额定值*中删除了引线温度和外壳温度 4
- 更改了 *ESD 等级* 表中的器件列表及其电压值 4
- 将*建议运行条件*说明中的“自然通风条件下的温度”更改为”环境温度“ 5
- 更改了*建议运行条件* 表中所有参数的表格条目 5
- 向“热性能信息”表中添加了几行，以及有关器件封装组合的表格注释 5
- 删除了*运行条件*表 17
- 向*典型特性* 部分添加了条件说明 25
- 将具体电压更改为*建议运行条件*引用 28
- 将单位增益带宽从所有器件为 0.7MHz 更改为 B 版本器件为 1.2MHz 29
- 将压摆率从所有器件均为 0.3V/µs 更改为 B 版本器件为 0.5V/µs 29
- 通篇多处更改了*输入共模范围* 部分 29
- 将*应用信息* 部分中的 V_{CC} 更改为 V_S 30
- 将 R_I 和 R_F 的后缀处理成了下标 30
- 更改了*非反相配置的运算放大器电路板布局*并添加了包含双通道运算放大器的图像 32

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

Changes from Revision T (April 2015) to Revision U (January 2017) **Page**

- 更改了数据表标题 1

Changes from Revision S (January 2014) to Revision T (April 2015) **Page**

- 添加了*应用* 部分、*ESD 等级* 表、*特性说明* 部分、*器件功能模式*、*应用和实施* 部分、*电源相关建议* 部分、*布局* 部分、*器件和文档支持* 部分以及*机械、封装和可订购信息* 部分 1

Changes from Revision R (July 2010) to Revision S (January 2014) **Page**

- 使用网上的 PDF 将此数据表从 QS 格式转换为 DocZone 1
- 删除了*订购信息* 表 1
- 更新了*特性* 部分以包含“军用免责声明” 1
- 添加了“典型特性”部分 25

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查看左侧的导航面板。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
5962-87710012A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710012A LM158FKB
5962-8771001PA	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771001PA LM158
5962-87710022A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710022A LM158AFKB
5962-8771002PA	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771002PA LM158A
LM158 MW8	Active	Production	WAFERSALE (YS) | 0	1 | NOT REQUIRED	-	Call TI	Level-1-NA-UNLIM	-55 to 125	
LM158AFKB	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710022A LM158AFKB
LM158AFKB.A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710022A LM158AFKB
LM158AJG	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM158AJG
LM158AJG.A	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM158AJG
LM158AJGB	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771002PA LM158A
LM158AJGB.A	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771002PA LM158A
LM158FKB	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710012A LM158FKB
LM158FKB.A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87710012A LM158FKB
LM158JG	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM158JG
LM158JG.A	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	LM158JG
LM158JGB	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771001PA LM158

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM158JGB.A	Active	Production	CDIP (JG) | 8	50 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	8771001PA LM158
LM258ADGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M3L, M3P, M3S, M3U)
LM258ADGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M3L, M3P, M3S, M3U)
LM258ADGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M3L, M3P, M3S, M3U)
LM258ADR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258ADR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258ADR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258ADRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258ADRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258ADRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258A
LM258AP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258AP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258AP.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258APE4	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258APE4.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258APE4.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258AP
LM258DGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M2L, M2P, M2S, M2U)
LM258DGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M2L, M2P, M2S, M2U)
LM258DGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	(M2L, M2P, M2S, M2U)
LM258DR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258
LM258DR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258
LM258DR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258
LM258DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-25 to 85	LM258
LM258DRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258
LM258DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM258DRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-25 to 85	LM258
LM258P	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU | SN	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258P
LM258P.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258P
LM258P.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258P
LM258PE4	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258P
LM258PE4.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-25 to 85	LM258P
LM2904AVQDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQDRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904AVQPWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904AV
LM2904BAIDDFR	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904A
LM2904BAIDDFR.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904A
LM2904BAIDDFR.B	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904A
LM2904BAIDGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28CB
LM2904BAIDGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28CB
LM2904BAIDGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28CB
LM2904BAIDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BAIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BAIDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BAIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BAIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BAIPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904BA
LM2904BIDDFR	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM2904BIDDFR.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904BIDDFR.B	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904BIDGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28BB
LM2904BIDGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28BB
LM2904BIDGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	28BB
LM2904BIDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIDRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904BIPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904B
LM2904DE4	NRND	Production	null (null) |	75 | TUBE	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
LM2904DGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(MBL, MBP, MBS, MBU)
LM2904DGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(MBL, MBP, MBS, MBU)
LM2904DGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(MBL, MBP, MBS, MBU)
LM2904DR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2904
LM2904DR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2904
LM2904DR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM2904
LM2904DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2904
LM2904DRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	LM2904
LM2904P	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P
LM2904P.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P
LM2904P.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P
LM2904PE4	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P
LM2904PE4.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM2904PE4.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 125	LM2904P
LM2904PSR	Active	Production	SO (PS) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904PSR.A	Active	Production	SO (PS) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2904
LM2904PWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904
LM2904PWRG3	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2904
LM2904PWRG4-JF	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	L2904
LM2904QDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904Q1
LM2904QDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904Q1
LM2904QDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2904Q1
LM2904QDRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
LM2904VQDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQDRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM2904VQPWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	L2904V
LM358ADE4	NRND	Production	null (null) |	75 | TUBE	-	Call TI	Call TI	0 to 70	
LM358ADGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	(M6L, M6P, M6S, M6U)
LM358ADGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	(M6L, M6P, M6S, M6U)
LM358ADGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	(M6L, M6P, M6S, M6U)

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM358ADR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358A
LM358ADR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358A
LM358ADR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358A
LM358AP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358AP
LM358AP.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358AP
LM358APE4	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358AP
LM358APE4.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358AP
LM358APE4.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358AP
LM358APW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L358A
LM358APWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358A
LM358APWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358A
LM358BAIDDFR	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDDFR.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDDFR.B	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDDFRG4	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDDFRG4.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDDFRG4.B	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	358BA
LM358BAIDGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	28DB
LM358BAIDGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	28DB
LM358BAIDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIDRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BAIPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L358BA
LM358BIDDFR	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358
LM358BIDDFR.B	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358
LM358BIDGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1TKR, 358B)

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM358BIDGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1TKR, 358B)
LM358BIDGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1TKR, 358B)
LM358BIDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIDR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIDRG4.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358BIPWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	LM358B
LM358D	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM358
LM358DGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	(M5L, M5P, M5S, M5U)
LM358DGKR.B	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	(M5L, M5P, M5S, M5U)
LM358DR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358
LM358DR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358
LM358DR.B	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	LM358
LM358DRG3	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM358
LM358DRG4	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM358
LM358P	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P
LM358P.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P
LM358P.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P
LM358PE3	Obsolete	Production	PDIP (P) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	LM358P
LM358PE4	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P
LM358PE4.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P
LM358PE4.B	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	LM358P

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM358PSR	Active	Production	SO (PS) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358
LM358PSR.A	Active	Production	SO (PS) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358
LM358PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L358
LM358PWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358
LM358PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	L358
LM358PWRG3	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L358
LM358PWRG4-JF	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	L358

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LM258A, LM2904, LM2904B, LM2904BA :

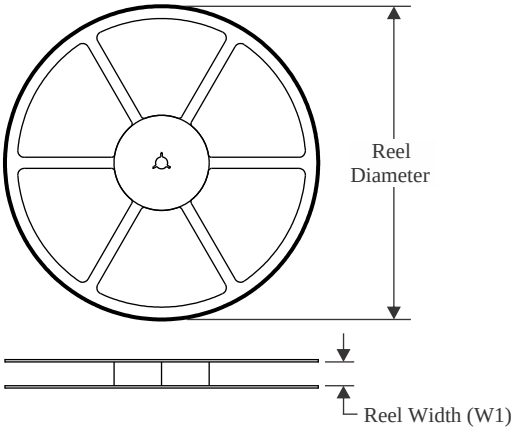
- Automotive : LM2904-Q1, LM2904B-Q1, LM2904BA-Q1
- Enhanced Product : LM258A-EP, LM2904-EP

NOTE: Qualified Version Definitions:

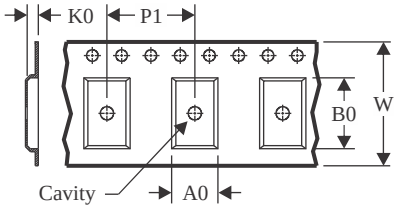
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

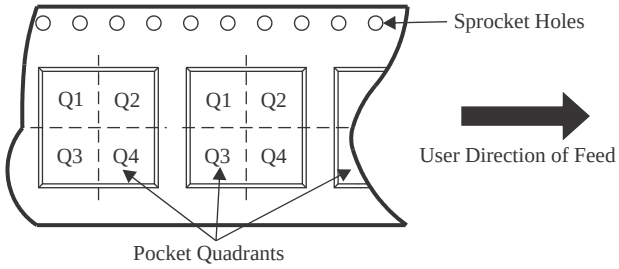


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



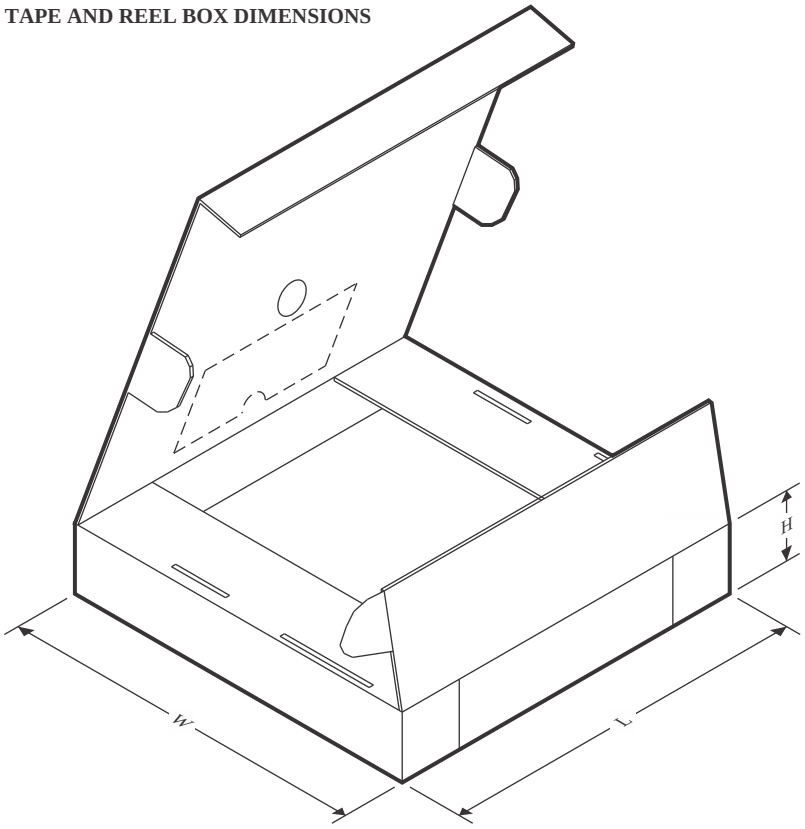
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM258ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258ADRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258ADRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM258DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM258DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258DRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM258DRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904AVQDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904AVQDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.5	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM2904AVQDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904AVQDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.5	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904AVQPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904AVQPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904BAIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM2904BAIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM2904BAIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904BAIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904BAIPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904BIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM2904BIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904BIPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM2904DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904PSR	SO	PS	8	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
LM2904PWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904QDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904VQDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.5	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904VQDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM2904VQPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM2904VQPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM358ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358APWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM358BAIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM358BAIDDFRG4	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM358BAIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BAIPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM358BIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
LM358BIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358BIPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM358BIPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM358DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
LM358DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.25	3.35	1.25	8.0	12.0	Q1
LM358DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358DR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
LM358PSR	SO	PS	8	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
LM358PWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



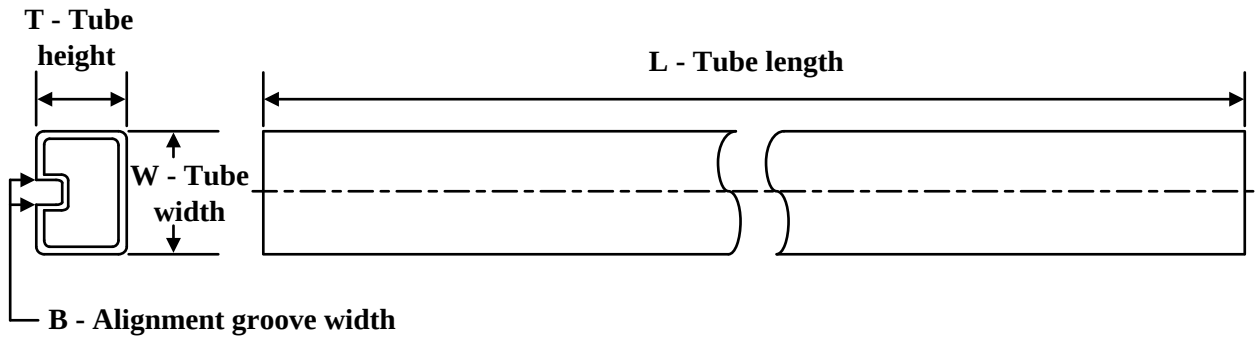
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	356.0	356.0	35.0
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM258ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM258ADR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM258ADR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM258ADRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM258ADRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM258DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	356.0	356.0	35.0
LM258DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM258DR	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM258DR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM258DR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM258DRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM258DRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM2904AVQDR	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM2904AVQDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904AVQDRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM2904AVQDRG4	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM2904AVQPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904AVQPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904BAIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
LM2904BAIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM2904BAIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904BAIDR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM2904BAIPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904BIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
LM2904BIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904BIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904BIPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	356.0	356.0	35.0
LM2904DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904DR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM2904PSR	SO	PS	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904PWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904QDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904VQDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM2904VQDRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM2904VQPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM2904VQPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358ADGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM358ADR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358APWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358BAIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
LM358BAIDDFRG4	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
LM358BAIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM358BAIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358BAIPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358BIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
LM358BIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358BIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM358BIDRG4	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM358BIDRG4	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358BIPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358BIPWRG4	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	356.0	356.0	35.0
LM358DGKR	VSSOP	DGK	8	2500	366.0	364.0	50.0
LM358DR	SOIC	D	8	2500	340.5	336.1	25.0
LM358DR	SOIC	D	8	2500	340.5	338.1	20.6
LM358DR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
LM358PSR	SO	PS	8	2000	353.0	353.0	32.0
LM358PWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
5962-87710012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
5962-87710022A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM158AFKB	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM158AFKB.A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM158FKB	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM158FKB.A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
LM258AP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258AP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258AP.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258APE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258APE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258APE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258P	P	PDIP	8	50	506.1	9	600	5.4
LM258P	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258P.A	P	PDIP	8	50	506.1	9	600	5.4
LM258P.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258P.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258P.B	P	PDIP	8	50	506.1	9	600	5.4
LM258PE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM258PE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904P	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904P.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904P.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904PE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904PE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM2904PE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358AP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358AP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358AP.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
LM358AP.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358APE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358P.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
LM358PE4.B	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32

GENERIC PACKAGE VIEW

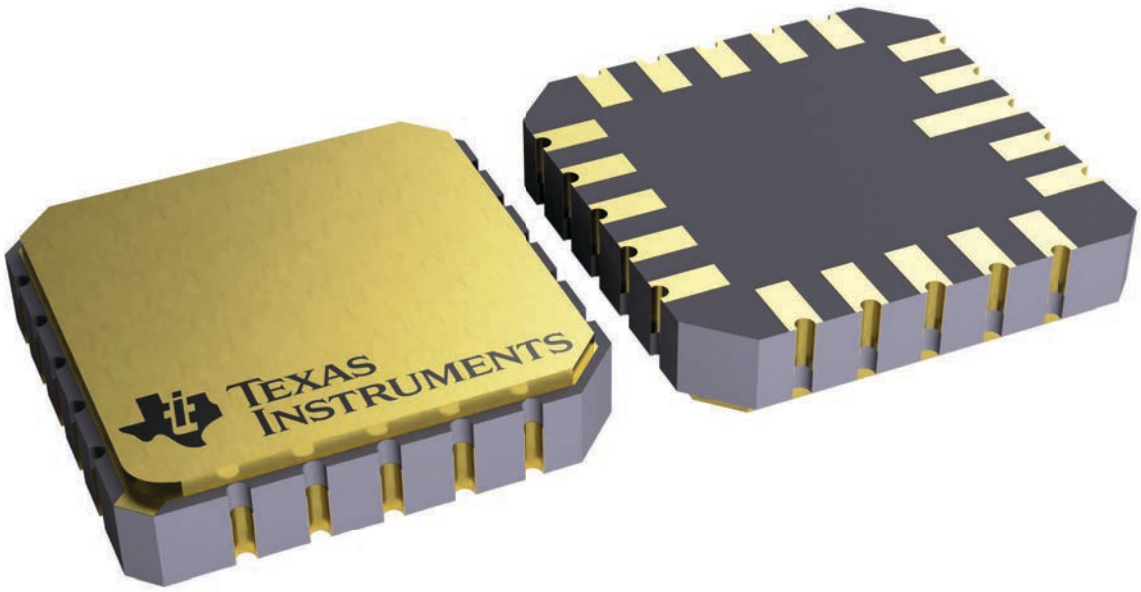
FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



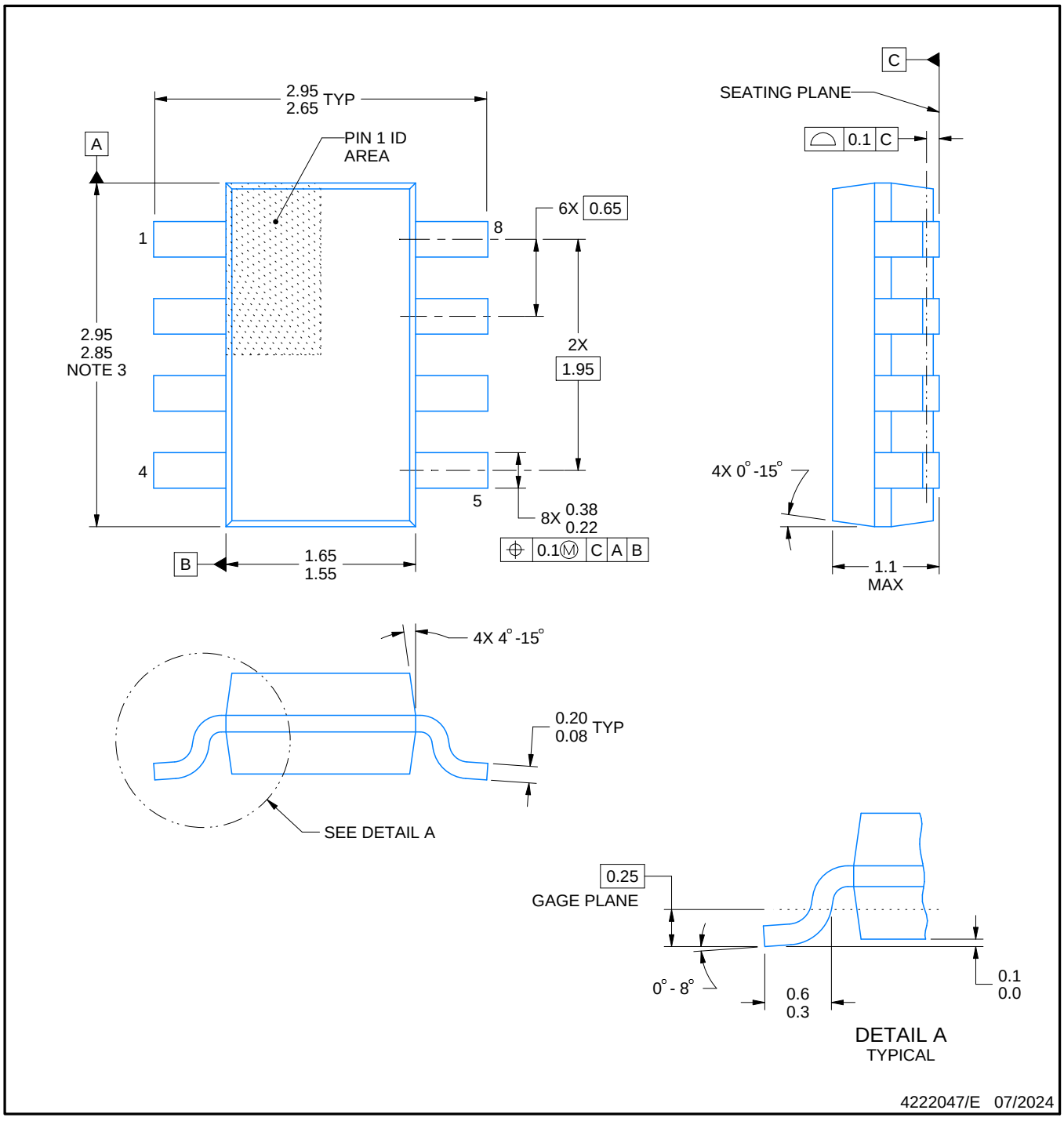
4229370VA\

PACKAGE OUTLINE

DDF0008A

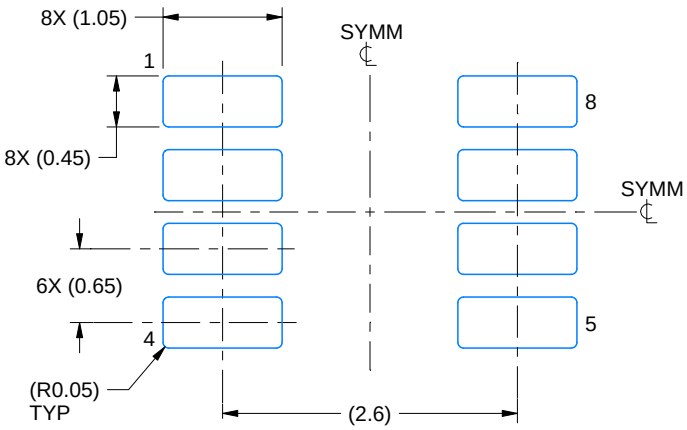
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE

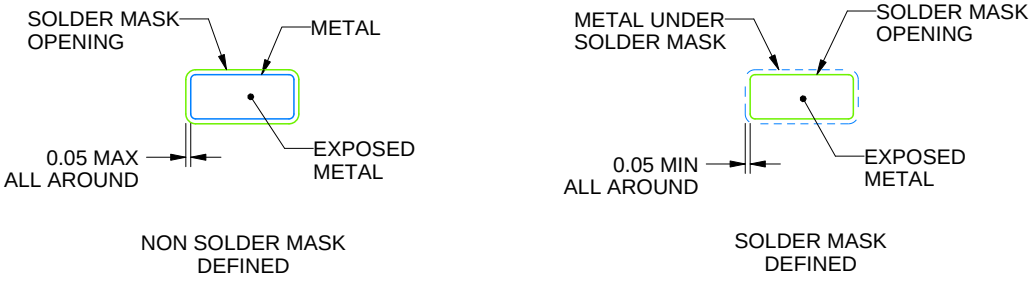


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

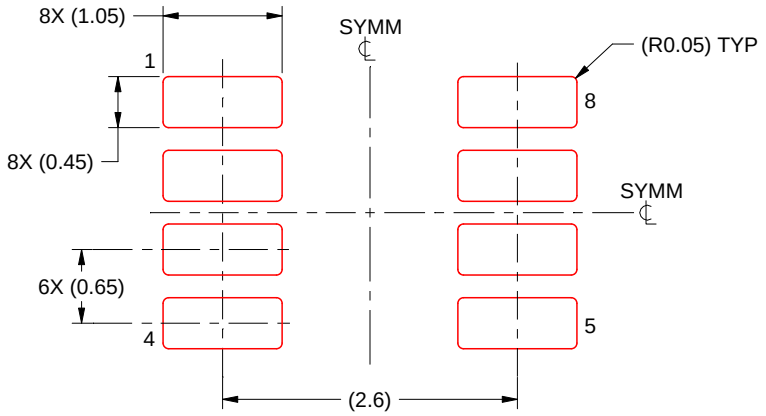


SOLDER MASK DETAILS

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

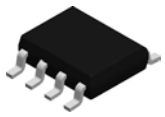


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

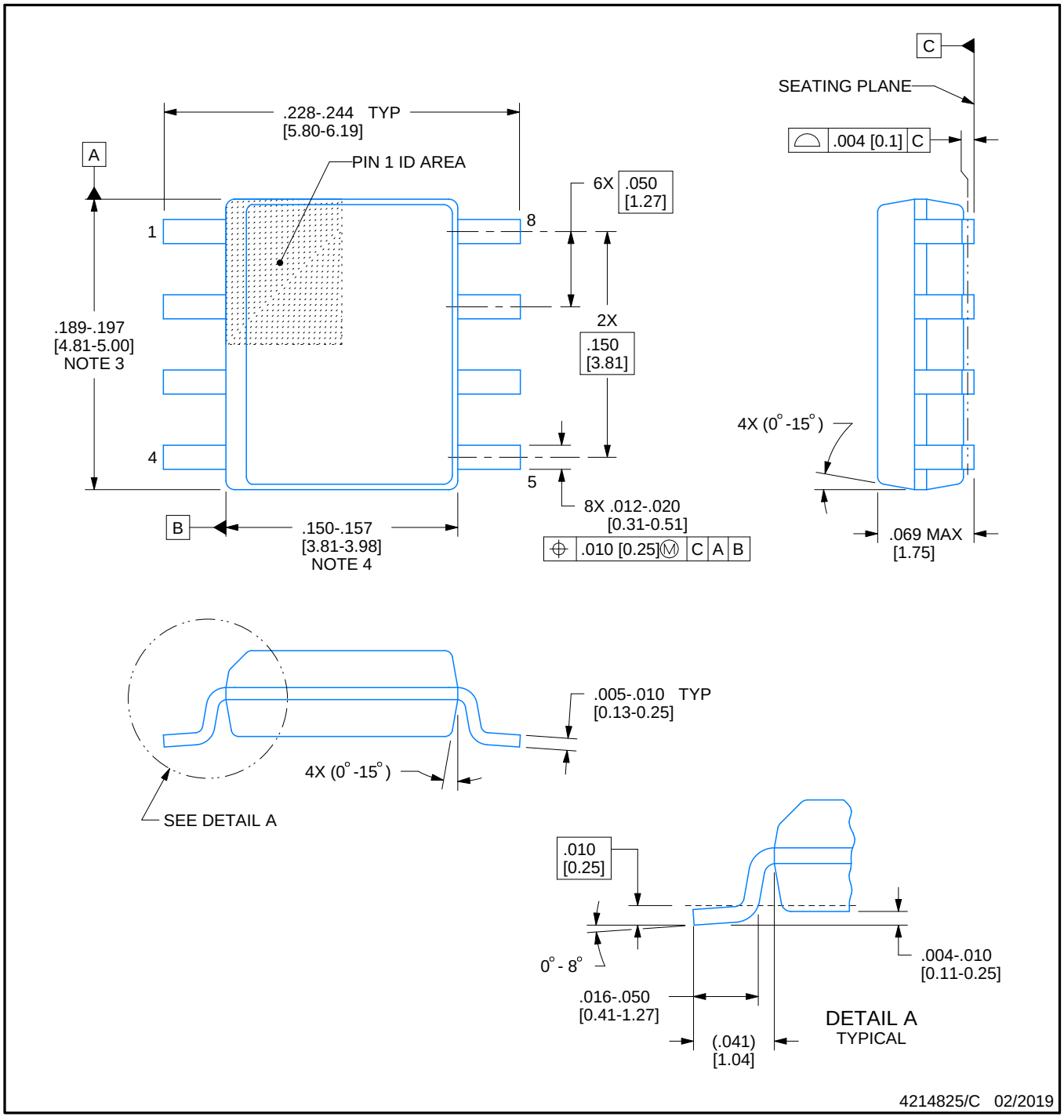


PACKAGE OUTLINE

D0008A

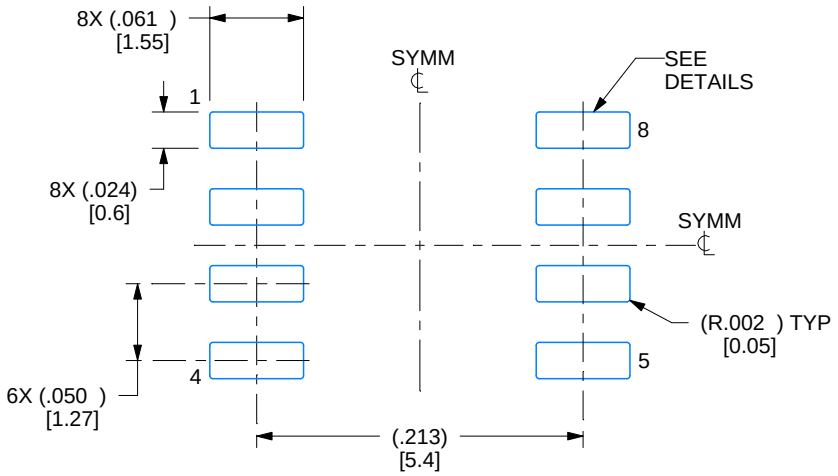
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

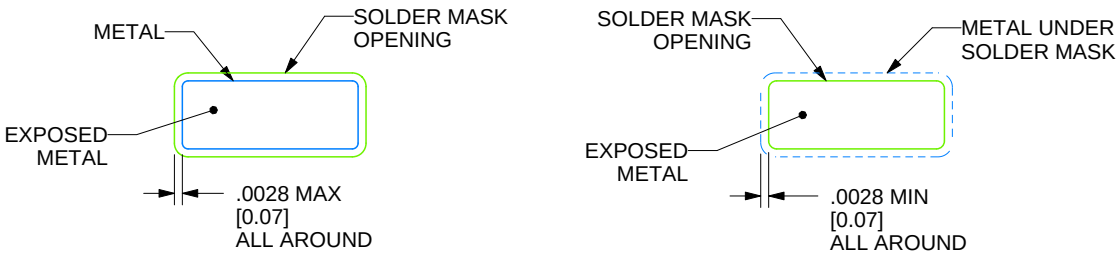


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

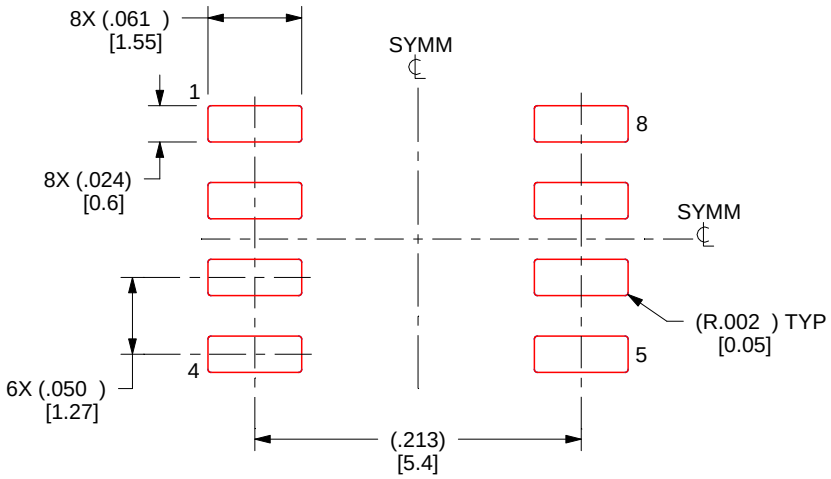
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

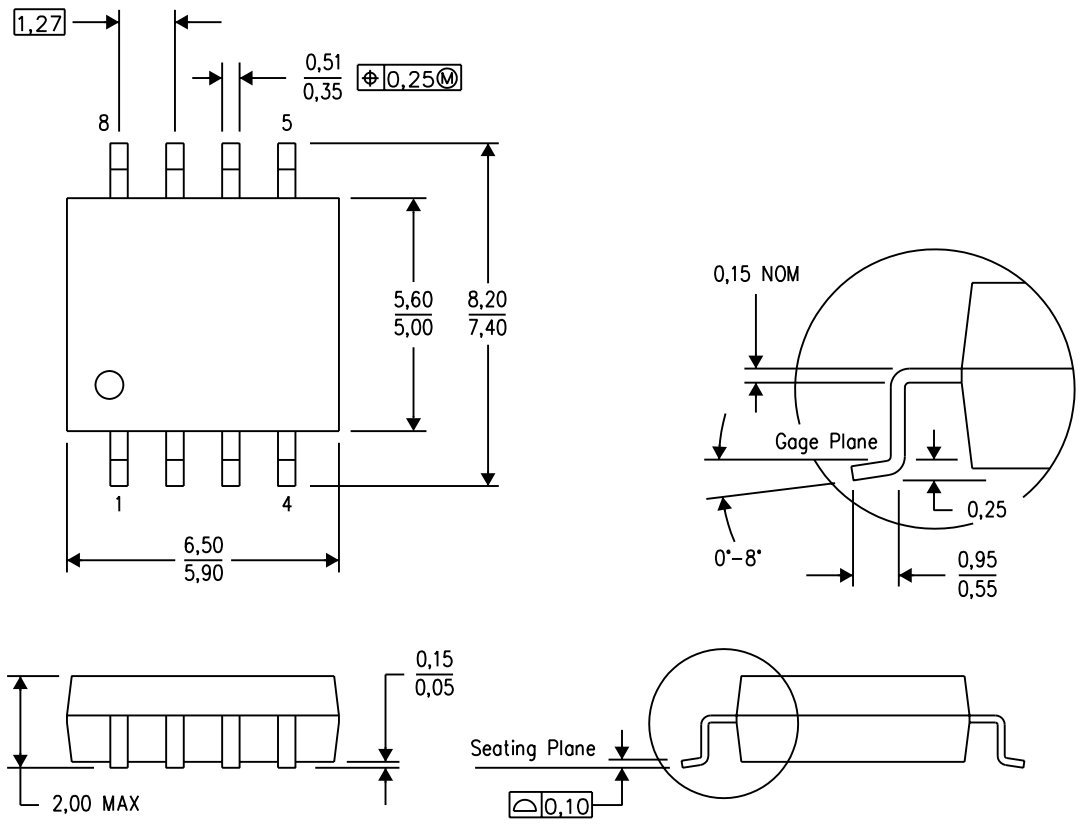
4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

MECHANICAL DATA

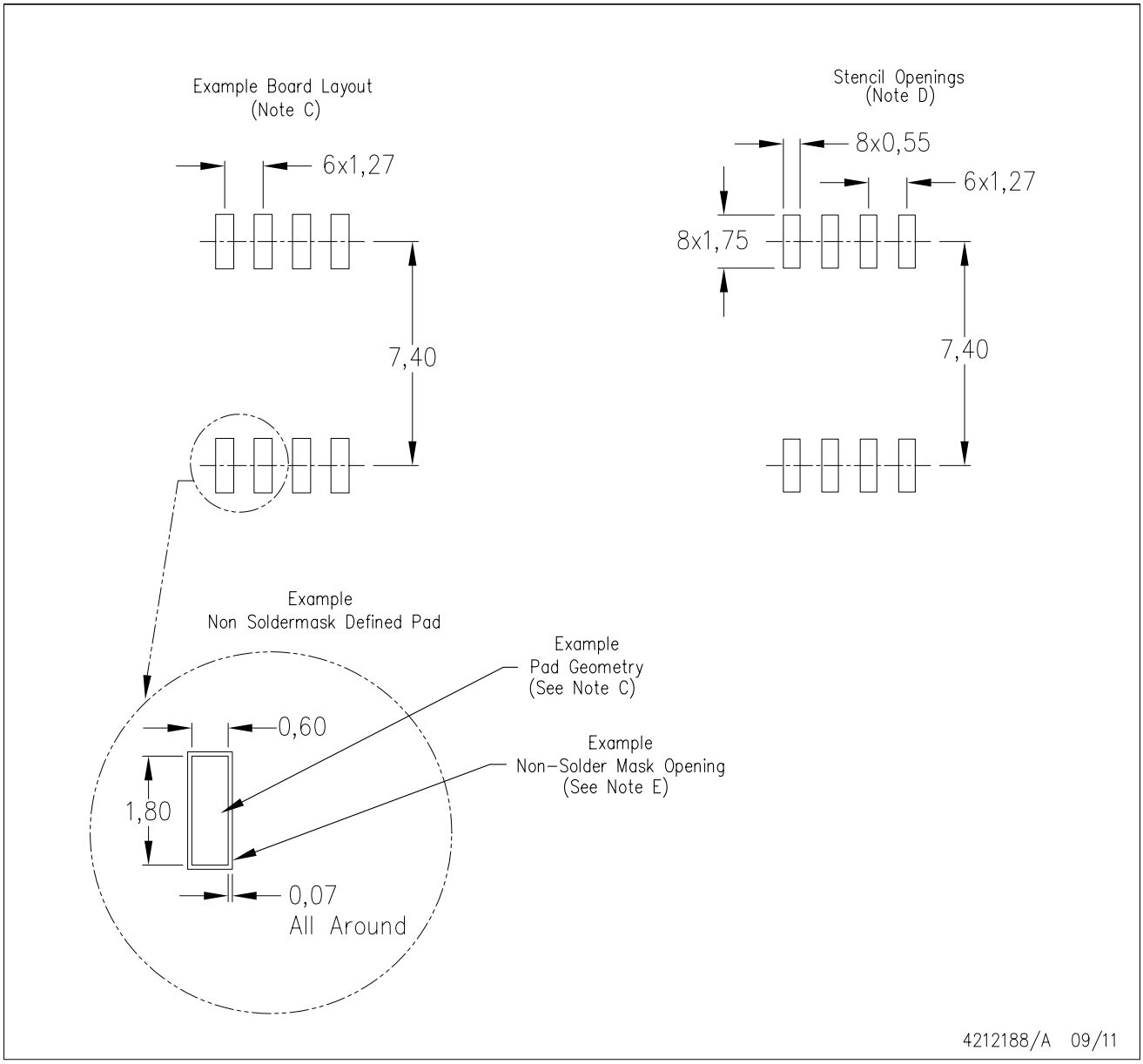
PS (R-PDSO-G8) **PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE**



4040063/C 03/03

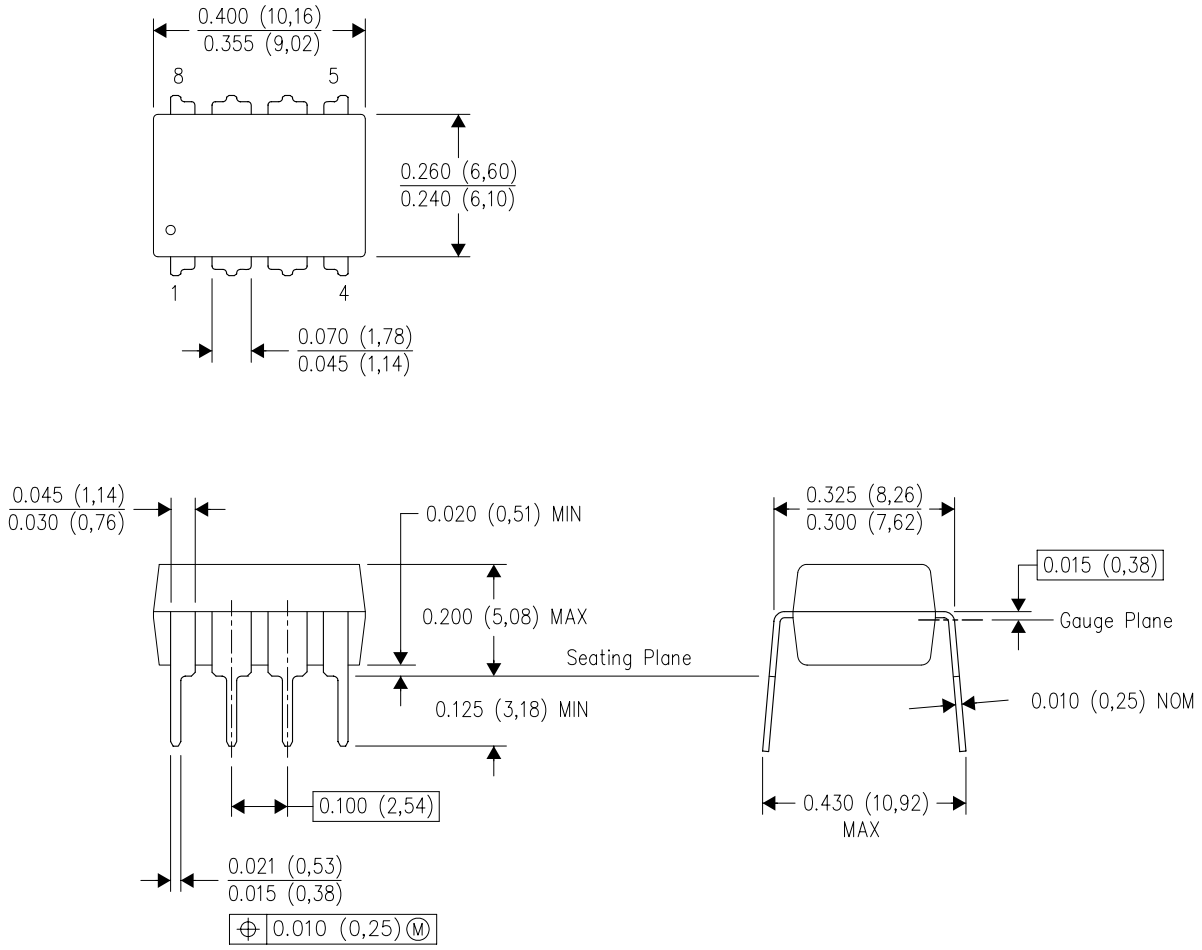
NOTES:
A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

PS (R–PDSO–G8) PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:
A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Publication IPC–7351 is recommended for alternate designs.
D. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC–7525 for other stencil recommendations.
E. Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

P (R–PDIP–T8) PLASTIC DUAL–IN–LINE PACKAGE



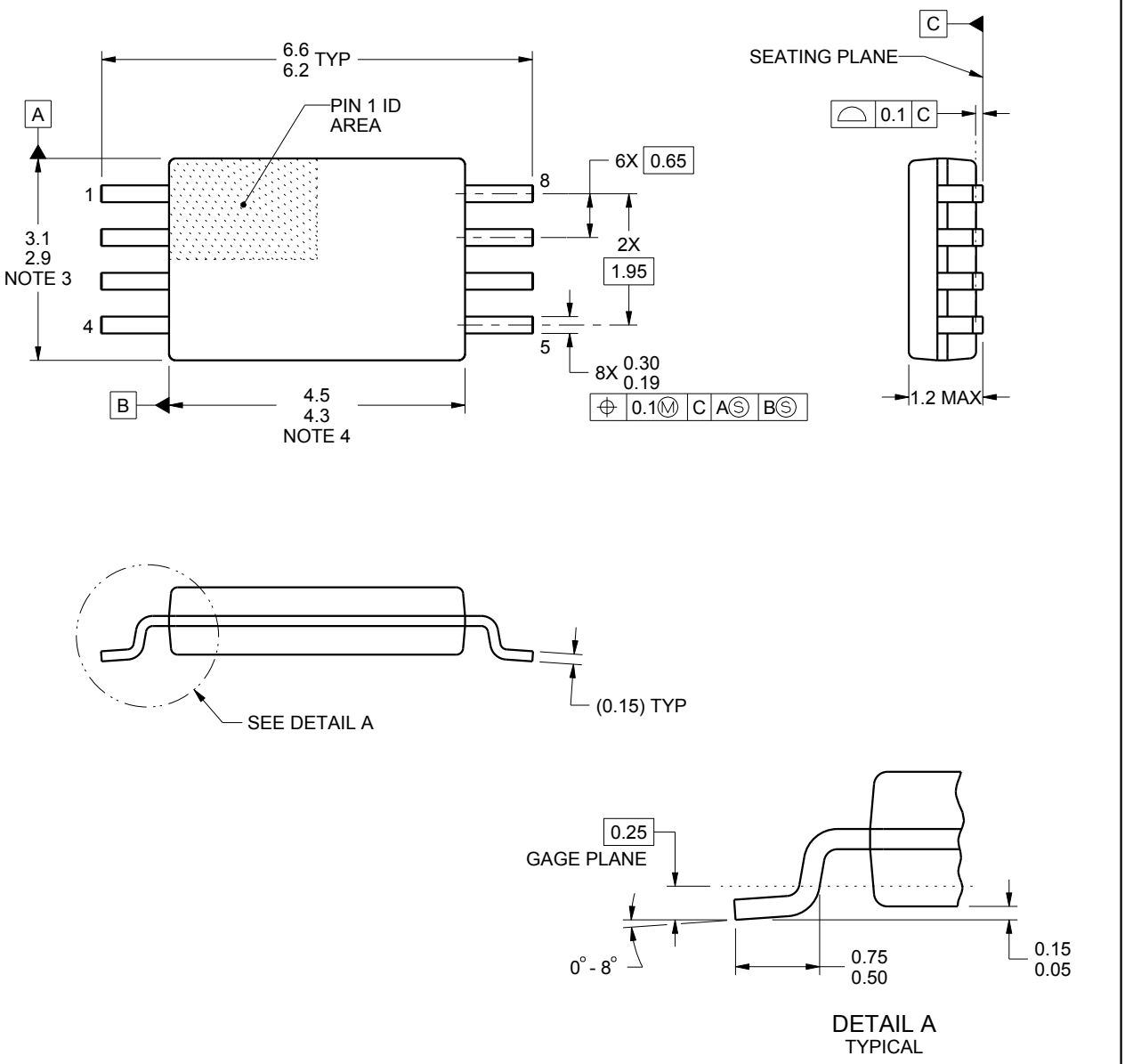
NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS–001 variation BA.

PACKAGE OUTLINE

PW0008A

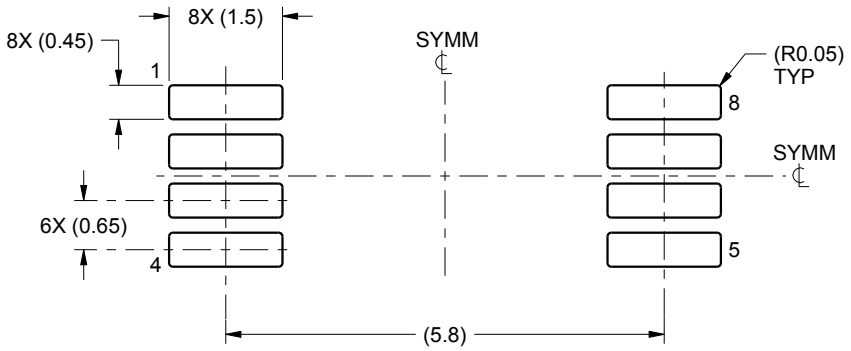
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

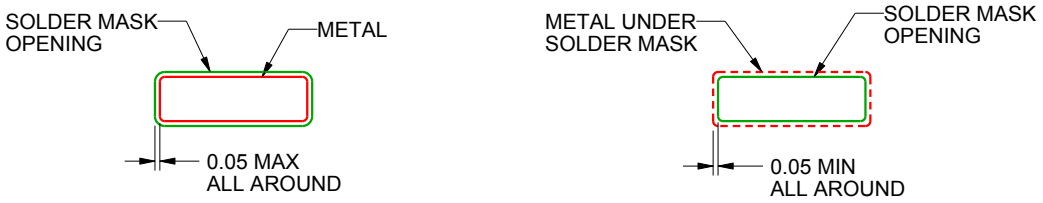


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X

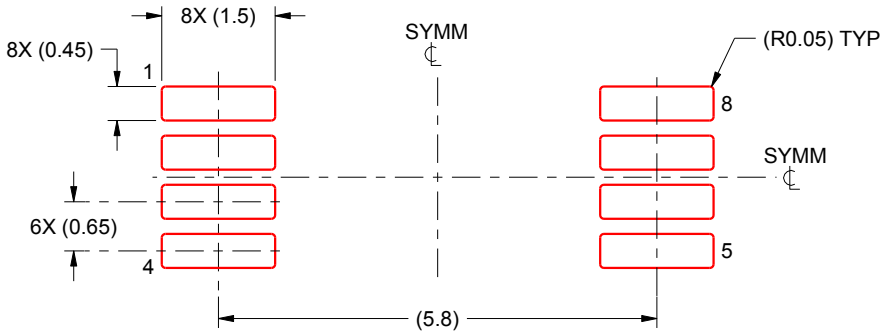


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

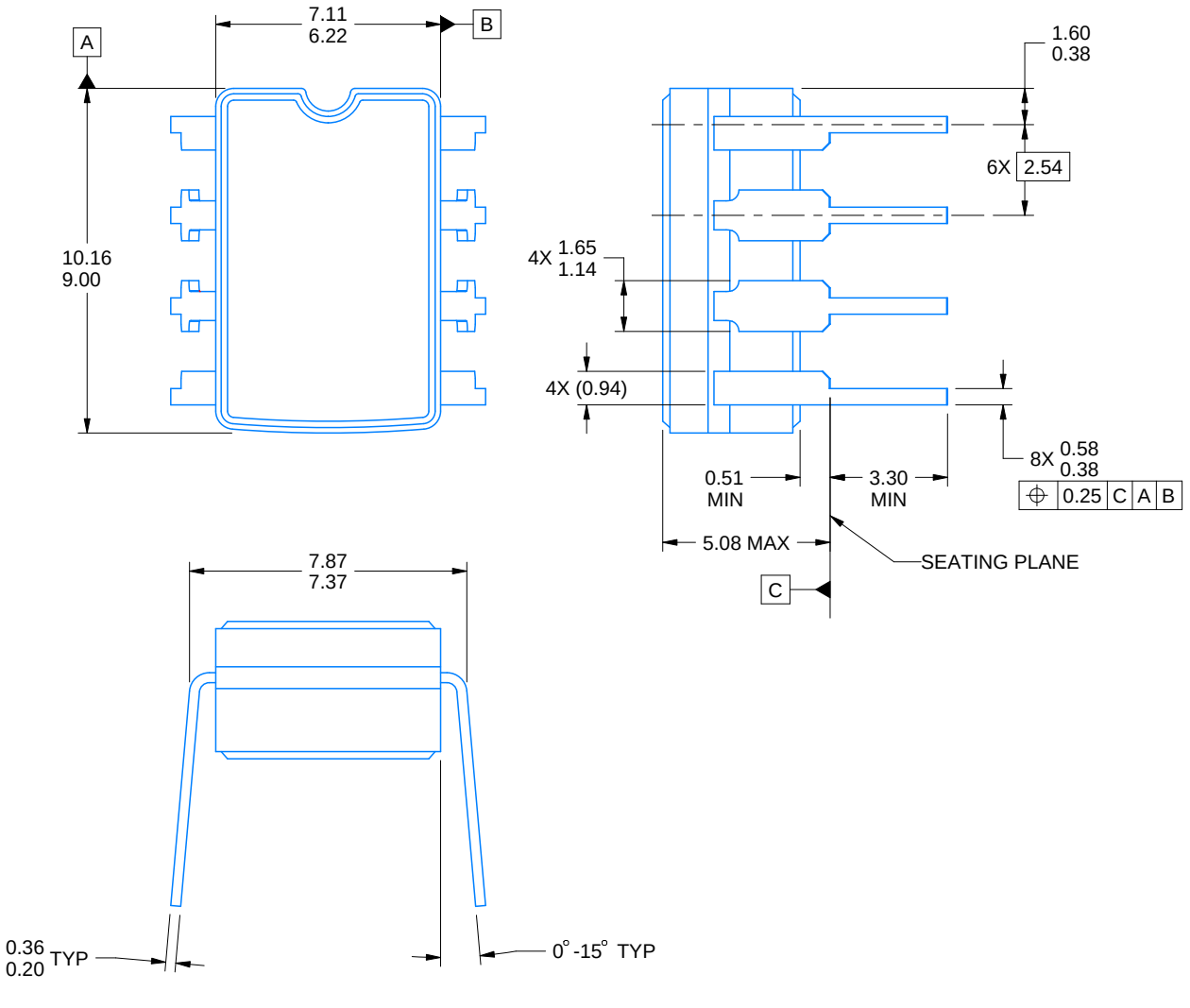
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

JG0008A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



4230036/A 09/2023

NOTES:

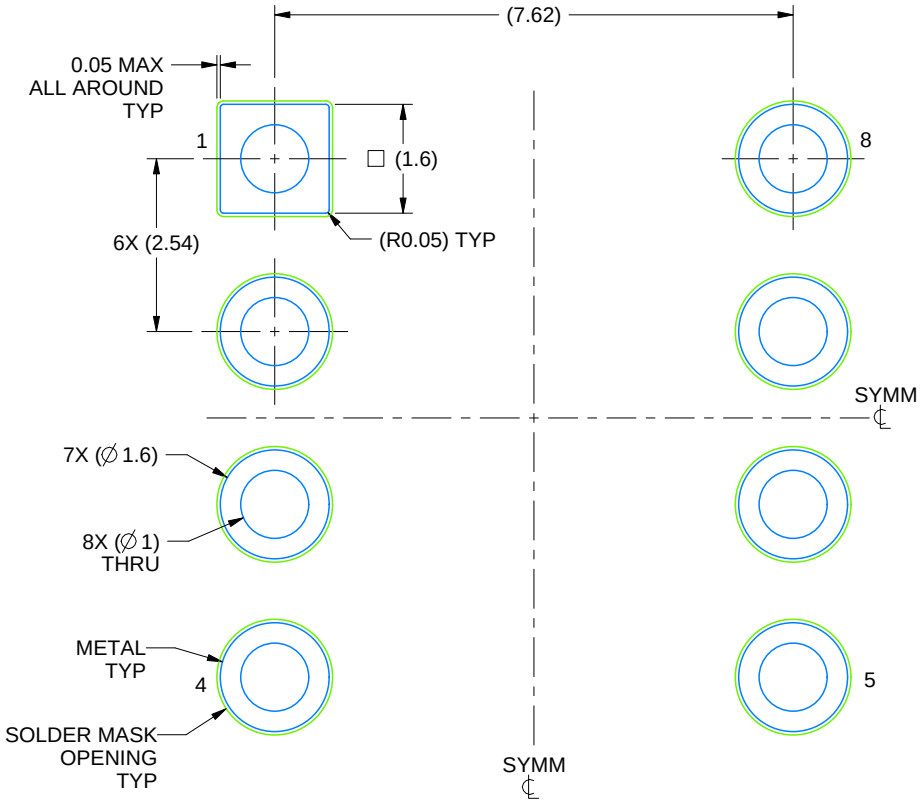
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification.
5. Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T8

EXAMPLE BOARD LAYOUT

JG0008A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 9X

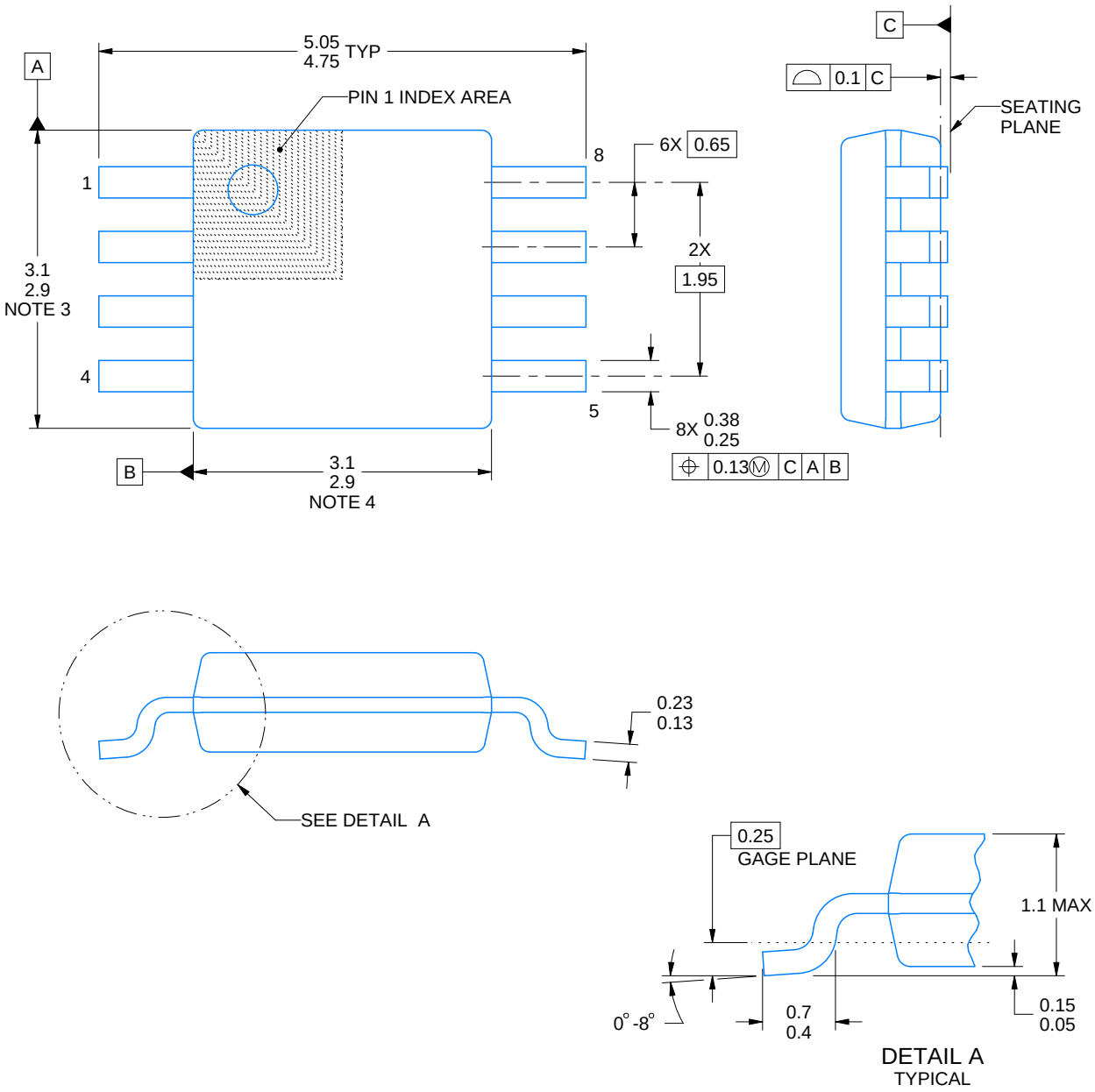
4230036/A 09/2023

PACKAGE OUTLINE

DGK0008A

VSSOP - 1.1 mm max height

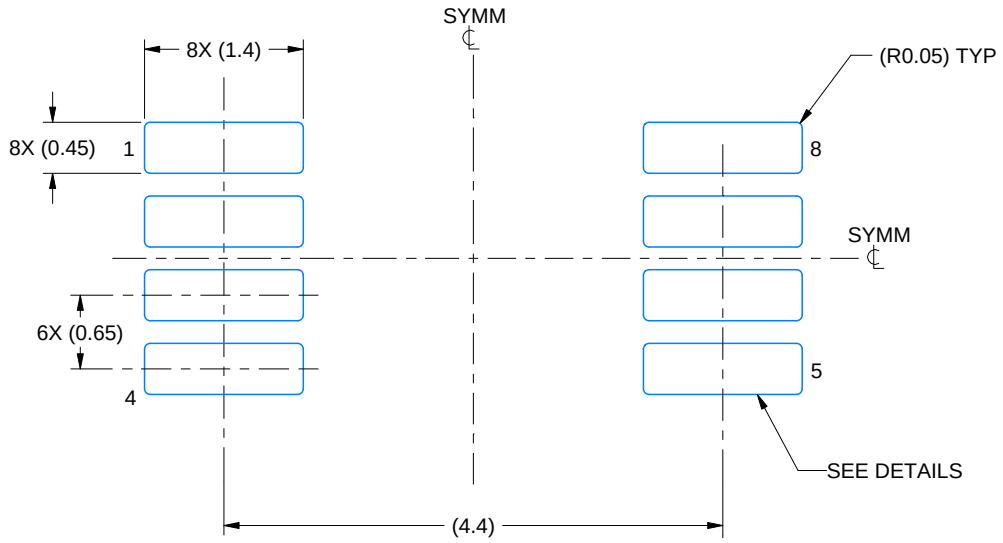
SMALL OUTLINE PACKAGE



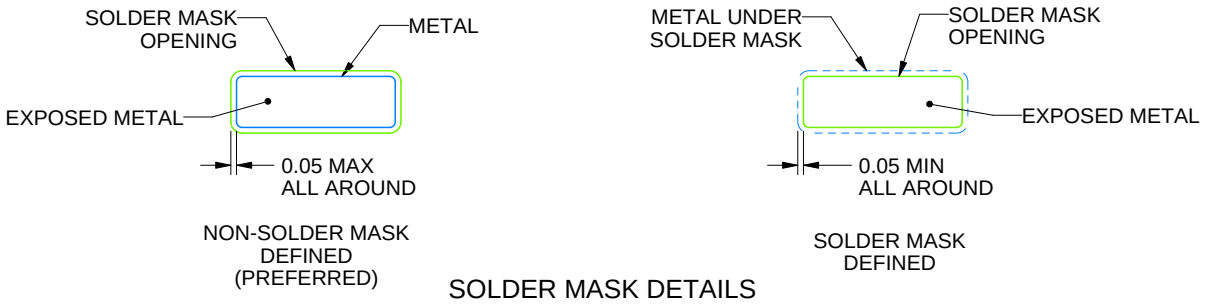
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X

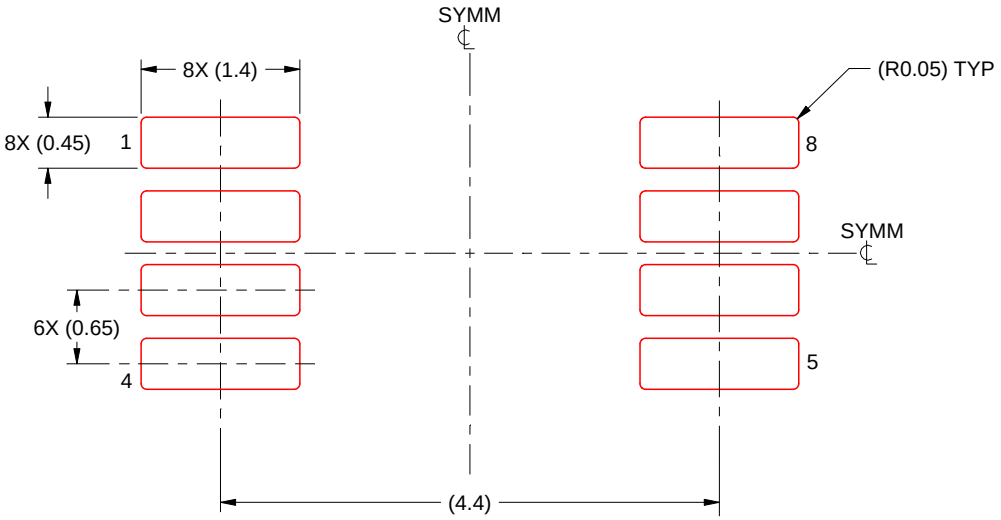


SOLDER MASK DETAILS

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.



SOLDER PASTE EXAMPLE
SCALE: 15X

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月